

INA701 采用 WCSP 封装和 5mΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位、I²C 输出数字电源监控器

1 特性

- 低损耗集成分流电阻器
 - 内部电阻： $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时为 $5\text{m}\Omega$
 - 电流额定值： $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时电流为 $\pm 6\text{A}$
- 高分辨率，16 位 Δ - Σ ADC
 - 宽共模范围： -0.3V 至 $+40\text{V}$
 - 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
 - 可编程转换时间和平均值计算
- 电流监控精度：
 - 总测量误差：1A 下为 $\pm 0.5\%$
 - 失调电流： $\pm 0.6\text{mA}$ (最大值)
 - 增益误差： $\pm 0.5\%$ (1A 时为最大值)
 - 增益误差漂移： $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (最大值)
- 电源监控精度：
 - 1A 电流下的精度为 0.85%
- 电能和电荷精度：
 - 1A 电流下的精度为 1.35%
- 内部监控和故障检测
- 精密振荡器： $\pm 0.5\%$ (最大值)
- 2.94MHz 高速 I²C 接口，支持 4 种引脚可配置地址
- 工作电源范围为 2.7V 至 5.5V
 - 工作电流： $640\mu\text{A}$ (典型值)
 - 关断电流： $5\mu\text{A}$ (最大值)

2 应用

- 笔记本电脑
- 智能手机
- 工业电池组
- 智能网络接口卡 (NIC)
- 硬件加速器卡

3 说明

INA701 是一款数字电源监控器，具有集成分流电阻器和专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ - Σ ADC。该器件可以测量高达 $\pm 6.225\text{A}$ 的满量程电流，共模电压范围为 -0.3V 至 $+40\text{V}$ 。

INA701 报告电流、总线电压、芯片温度、功率、能量和电荷累积，并采用精度为 $\pm 0.5\%$ 的集成振荡器，同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 $\pm 3^\circ\text{C}$ 。

INA701 具有低温漂和增益误差漂移，因此可用于在制造过程中不进行温度校准的系统。

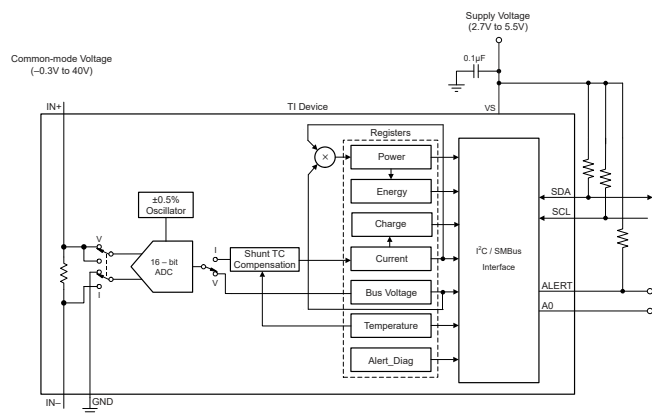
该器件支持选择从 $50\mu\text{s}$ 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值，这有助于进一步降低测量数据的噪声并能够优化过流检测窗口。

该器件采用微型 PowerWCSP (DSBGA) 封装，可更大幅度地减小解决方案尺寸并提高热性能。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
INA701	YWF (PowerWCSP, 8)	1.319mm × 1.239mm

- 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的封装选项附录。
- 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



简化版方框图



内容

1 特性	1	6.5 编程	21
2 应用	1	6.6 寄存器映射	23
3 说明	1	7 应用和实施	32
4 引脚配置和功能	3	7.1 应用信息.....	32
5 规格	4	7.2 典型应用.....	35
5.1 绝对最大额定值.....	4	8 电源相关建议	38
5.2 ESD 等级.....	4	9 布局	38
5.3 建议运行条件.....	4	9.1 布局指南.....	38
5.4 热性能信息.....	4	9.2 布局示例.....	38
5.5 电气特性.....	5	10 器件和文档支持	39
5.6 时序要求 (I ² C).....	7	10.1 文档支持.....	39
5.7 时序图.....	7	10.2 接收文档更新通知.....	39
5.8 典型特性.....	8	10.3 支持资源.....	39
6 详细说明	12	10.4 商标.....	39
6.1 概述.....	12	10.5 静电放电警告.....	39
6.2 功能方框图.....	12	10.6 术语表.....	39
6.3 特性说明.....	12	11 修订历史记录	39
6.4 器件功能模式.....	19	12 机械、封装和可订购信息	39

4 引脚配置和功能

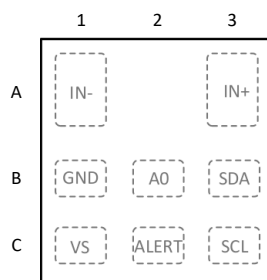


图 4-1. YWF 封装 8 引脚 PowerWCSOP 顶视图

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
编号	名称		
A1	IN -	模拟输入	器件的负输入。对于高侧应用，连接至负载的电源侧。对于低侧应用，请接地。
A3	IN+	模拟输入	器件的正输入。对于高侧应用，连接到总线电源。对于低侧应用，连接至负载的接地侧。
B1	GND	接地	接地。
B2	A0	数字输入	I ² C 地址引脚。连接到 GND、SCL、SDA 或 VS。有关可用器件地址的列表，请参阅表 6-2。
B3	SDA	数字输入/输出	开漏双向 I ² C 数据。
C1	VS	电源	电源，2.7V 至 5.5V。
C2	ALERT	数字输出	开漏警报输出，默认状态为低电平有效。
C3	SCL	数字输入	开漏 I ² C 时钟输入。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_S	电源电压		6	V
V_{IN+} , V_{IN-} ⁽²⁾	共模电压	-0.3	42	V
V_{ALERT}	ALERT	-0.3	$V_S + 0.3$	V
V_{IO}	SDA、SCL、A0	-0.3	6	V
I_{IN}	任何引脚的输入电流，不包括 $IN+$ 和 $IN-$		5	mA
I_{OUT}	数字输出电流		10	mA
T_J	结温		125	°C
T_{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) V_{IN+} 和 V_{IN-} 分别为 $IN+$ 和 $IN-$ 引脚上的电压。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准，所有引脚 ⁽²⁾	±1000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{CM}	共模输入电压	-0.3		40	V
V_S	运行电源电压	2.7		5.5	V
T_A	额定环境温度	-40		105	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		INA701	单位
		YWF (PowerWCSP)	
		8 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	108.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	0.7	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	30.8	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	0.2	°C/W
Υ_{JB}	结至电路板特征参数	30.8	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.5 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 3.3\text{V}$, $I_{\text{SENSE}} = 0\text{A}$, $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN-}} = V_{\text{BUS}} = 12\text{V}$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入						
CMRR	共模抑制	$0\text{V} < V_{\text{CM}} < 40\text{V}$, $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+105^\circ\text{C}$	± 1	± 30		$\mu\text{A/V}$
I_{os}	输入失调电流	$T_{\text{CT}} > 280\mu\text{s}$	± 0.190	± 0.6		mA
dI_{os}/dT	输入失调电流漂移	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+105^\circ\text{C}$	± 20	± 100		$\mu\text{A}/^\circ\text{C}$
PSRR	输入失调电流与电源间的关系	$V_S = 2.7\text{V}$ 至 5.5V , $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+105^\circ\text{C}$	± 0.02	± 0.28		mA/V
$V_{\text{os_bus}}$	V_{BUS} 失调电压		± 6.2	± 15		mV
dV_{os}/dT	V_{BUS} 失调电压偏移	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+105^\circ\text{C}$	± 4	± 40		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	V_{BUS} 失调电压与电源间的关系	$V_S = 2.7\text{V}$ 至 5.5V	± 1.1			mV/V
直流精度						
G_{SERR}	系统电流检测增益误差 ⁽¹⁾	$I_{\text{SENSE}} = 1\text{A}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$	± 0.1	± 0.5		%
		$I_{\text{SENSE}} = 3\text{A}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$	± 0.5			%
$G_{\text{S_DRFT}}$	系统电流检测增益误差漂移	$-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 105^\circ\text{C}$	± 15	± 50		$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
G_{BERR}	V_{BUS} 电压增益误差	$V_{\text{CM}} = 0\text{V}$ 至 40V , $T_A = 25^\circ\text{C}$	± 0.05	± 0.2		%
$G_{\text{B_DRFT}}$	V_{BUS} 电压增益误差偏移	$-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 105^\circ\text{C}$		± 30		$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
I_{BUS}	V_{BUS} 漏电流	通过有效转换启用器件	12			μA
P_{TME}	功率总测量误差 (TME)	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{\text{CM}} = 12\text{V}$, $I_{\text{LOAD}} = 1\text{A}$	± 0.15	± 0.85		%
E_{TME}	电能和电荷 TME	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{\text{CM}} = 12\text{V}$, $I_{\text{LOAD}} = 1\text{A}$	± 0.25	± 1.35		%
	ADC 分辨率		16			位
	1 个最低有效位 (LSB) 阶跃幅度	电流	190			μA
		总线电压	3.125			mV
		温度	125			m°C
		电源	38			μW
		电能	0.608			mJ
		电荷	11.875			μC
T_{CT}	ADC 转换时间 ⁽²⁾	转换时间字段 = 0h	50			μs
		转换时间字段 = 1h	84			
		转换时间字段 = 2h	150			
		转换时间字段 = 3h	280			
		转换时间字段 = 4h	540			
		转换时间字段 = 5h	1052			
		转换时间字段 = 6h	2074			
		转换时间字段 = 7h	4120			
INL	积分非线性	内部 ADC	± 5			m%
时钟源						
F_{OSC}	内部振荡器频率		1			MHz
OSC_{TOL}	内部振荡器频率容限	$T_A = 25^\circ\text{C}$	± 0.07	± 0.5		%
		$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+105^\circ\text{C}$	± 0.14	± 1		%

$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_S = 3.3\text{V}$, $I_{\text{SENSE}} = 0\text{A}$, $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN-}} = V_{\text{BUS}} = 12\text{V}$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
温度传感器						
	测量范围		-40		+125	°C
	温度精度	T _J = 25°C		+1.3	±2.5	°C
		T _J = - 40°C 至 +125°C		+1.5	±3	°C
集成分流器						
	内部开尔文电阻	T _A = 25°C		5		m Ω
	引脚对引脚封装电阻	IN+ 至 IN - , T _A = 25°C	5.6	7	8.4	m Ω
	最大分流电流 ⁽³⁾	T _A = 25°C			±6	A
		T _A = 85°C			±5	A
	短路时间过载变化	I _{SENSE} = 12A 并持续 5 秒		±0.01		%
	因温度循环而变化	- 55°C ≤ T _J ≤ 125°C , 700 个周期		±0.2		%
	焊接热导致的电阻变化	260°C 焊料, 10s		±0.03		%
	负载寿命变化	1000 小时, T _J = 125°C , I _{SENSE} = 4A , 100% 负载		±0.1		%
	高温暴露变化	1000 小时, T _A = 150°C , 未偏置		±0.7		%
	低温贮存变化	24 小时, T _A = -65°C , 未偏置		±0.2		%
电源						
V _S	电源电压		2.7		5.5	V
I _Q	静态电流	V _{SENSE} = 0V		640	700	μA
		V _{SENSE} = 0V , T _A = - 40°C 至 +105°C			1.1	mA
I _{QSD}	静态电流, 关断	关断模式		2.8	5	μA
T _{POR}	器件启动时间	加电 (NPOR)		300		μs
		从关断模式		60		
数字输入/输出						
V _{IH}	逻辑输入电平, 高	SDA、SCL	1.2		5.5	V
V _{IL}	逻辑输入电平, 低		GND		0.4	V
V _{OL}	逻辑输出电平, 低	I _{OL} = 3mA	GND		0.4	V
I _{IO_LEAK}	数字泄漏输入电流	0 ≤ V _{IN} ≤ V _S	-1		1	μA

(1) 包括焊接和器件寿命变化。 不包括分流器中的漂移; 请参阅“负载寿命”规格以了解分流器老化漂移。

(2) 取决于振荡器精度和偏移

(3) 有关其他电流限制, 请参阅图 6-4

5.6 时序要求 (I²C)

		最小值	标称值	最大值	单位
I²C 总线 (快速模式)					
F _(SCL)	I ² C 时钟频率	1		400	kHz
t _(BUF)	停止和启动条件之间的总线空闲时间	600			ns
t _(HDSTA)	重复 START 条件后的保持时间。在此周期后, 生成第一个时钟。	100			ns
t _(SUSTA)	重复启动条件建立时间	100			ns
t _(SUSTO)	停止条件建立时间	100			ns
t _(HDDAT)	数据保持时间	10		900	ns
t _(SUDAT)	数据设置时间	100			ns
t _(LOW)	SCL 时钟低电平周期	1300			ns
t _(HIGH)	SCL 时钟高电平周期	600			ns
t _F	数据下降时间			300	ns
t _F	时钟下降时间			300	ns
t _R	时钟上升时间			300	ns
I²C 总线 (高速模式)					
F _(SCL)	I ² C 时钟频率	10		2940	kHz
t _(BUF)	停止和启动条件之间的总线空闲时间	160			ns
t _(HDSTA)	重复 START 条件后的保持时间。在此周期后, 生成第一个时钟。	100			ns
t _(SUSTA)	重复启动条件建立时间	100			ns
t _(SUSTO)	停止条件建立时间	100			ns
t _(HDDAT)	数据保持时间	10		125	ns
t _(SUDAT)	数据设置时间	20			ns
t _(LOW)	SCL 时钟低电平周期	200			ns
t _(HIGH)	SCL 时钟高电平周期	60			ns
t _F	数据下降时间			80	ns
t _F	时钟下降时间			40	ns
t _R	时钟上升时间			40	ns

5.7 时序图

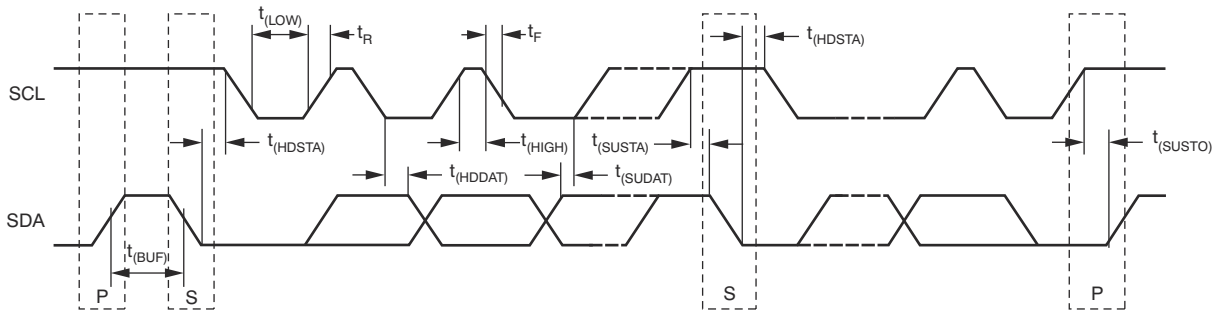


图 5-1. I²C 时序图

5.8 典型特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 12\text{V}$, $I_{SENSE} = 0\text{A}$ 和 $V_{VBS} = 12\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)

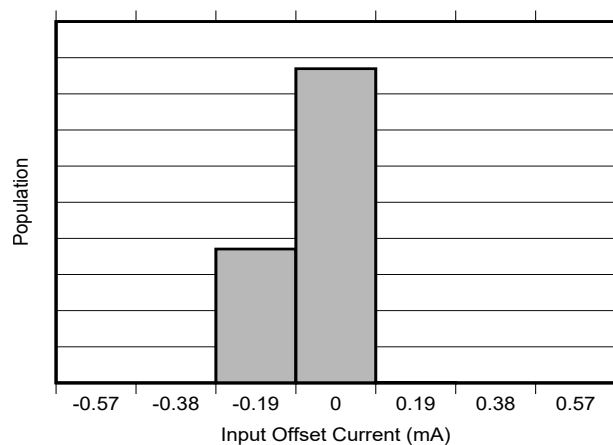


图 5-2. 输入偏移电流产生分布图

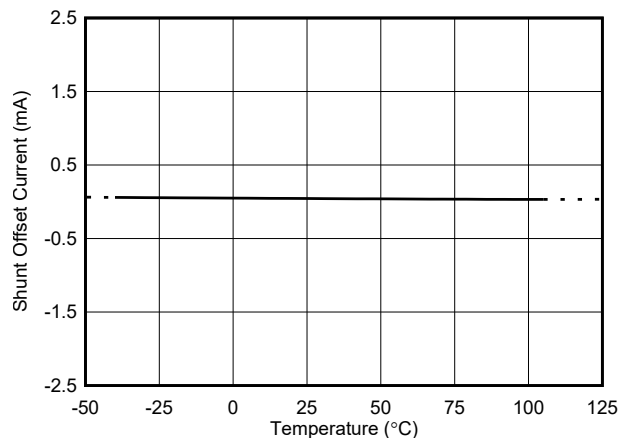


图 5-3. 输入失调电流与温度间的关系

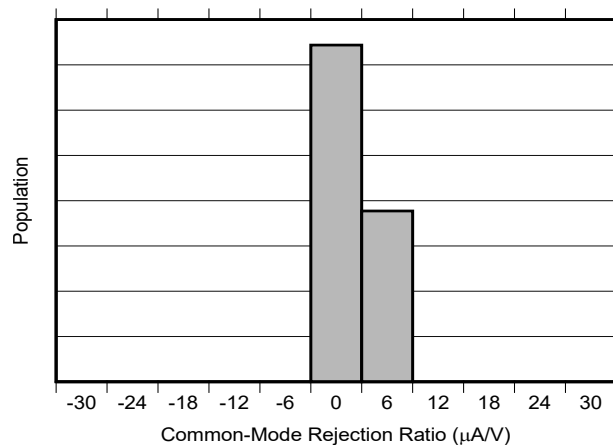


图 5-4. 共模抑制比产生分布图

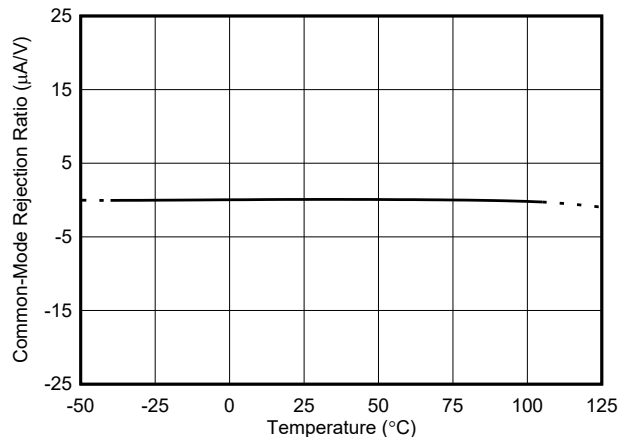


图 5-5. 共模抑制比与温度间的关系

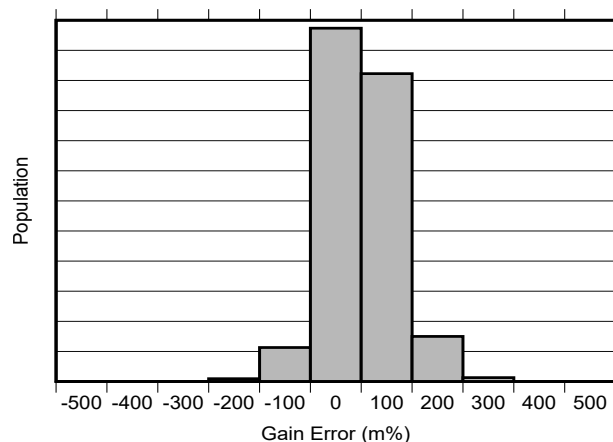


图 5-6. 电流测量增益误差产生分布图

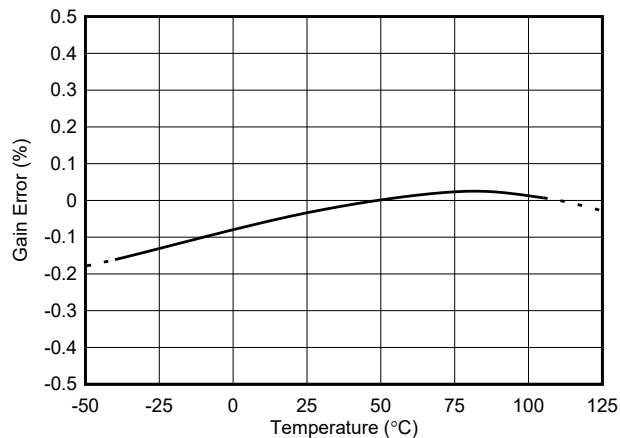


图 5-7. 电流测量增益误差与温度间的关系

5.8 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 12\text{V}$, $I_{SENSE} = 0\text{A}$ 和 $V_{VBUS} = 12\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)

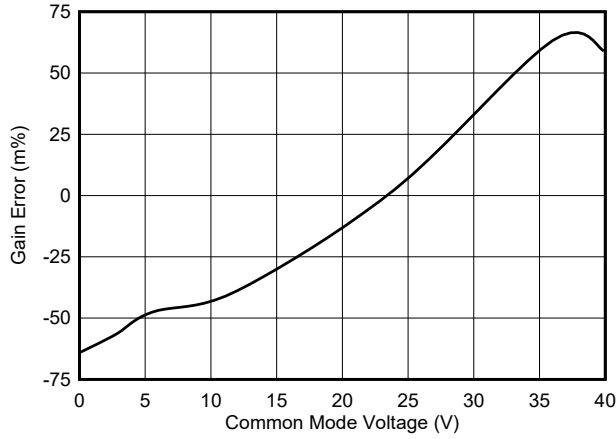


图 5-8. 电流测量增益误差与共模电压间的关系

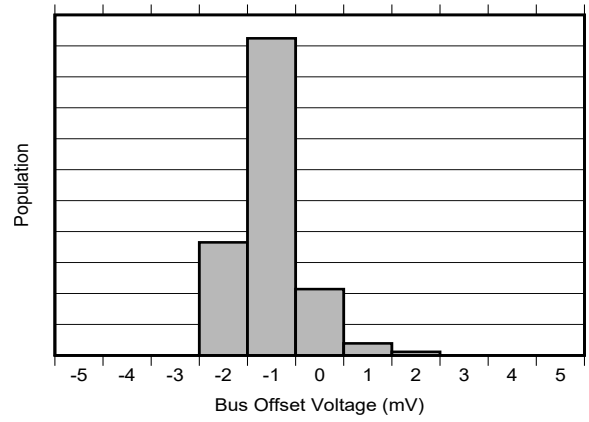


图 5-9. 总线电压偏移产生分布图

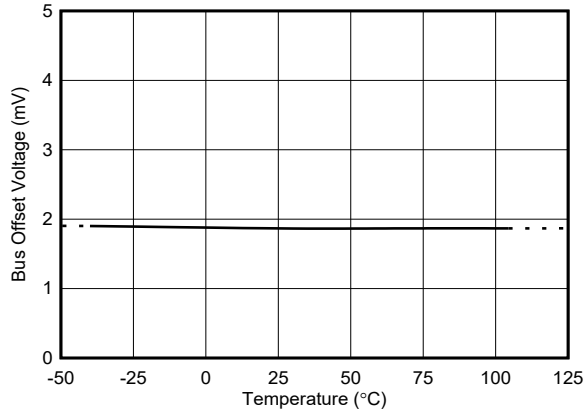


图 5-10. 总线电压偏移与温度间的关系

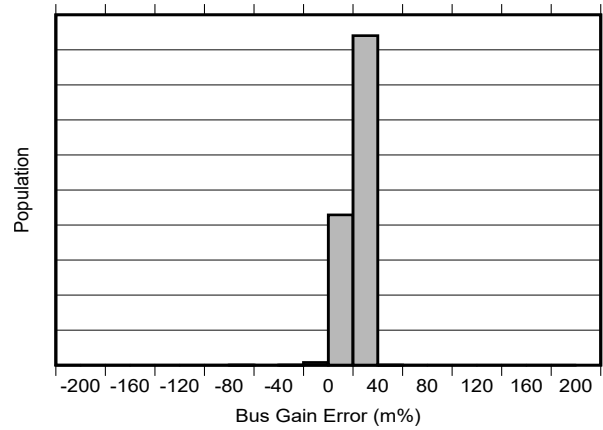


图 5-11. 总线电压增益误差产生分布图

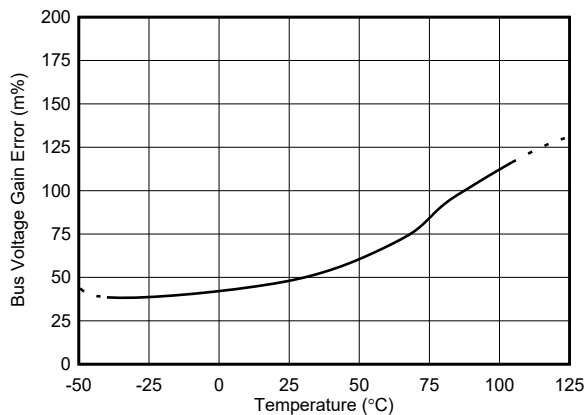


图 5-12. 总线电压增益误差与温度间的关系

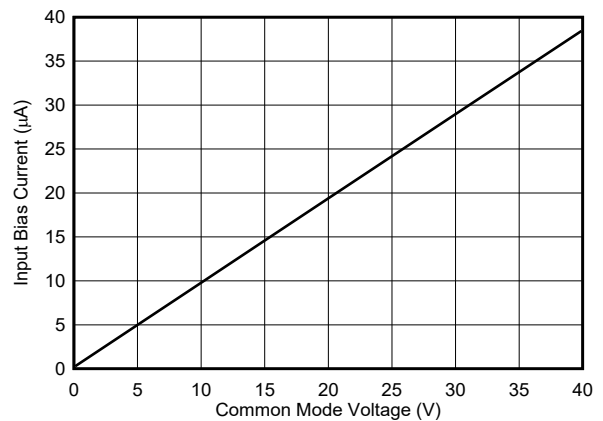


图 5-13. 输入偏置电流 ($I_{B^+} + I_{B^-}$) 与共模电压间的关系

5.8 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 12\text{V}$, $I_{\text{SENSE}} = 0\text{A}$ 和 $V_{\text{VBUS}} = 12\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)

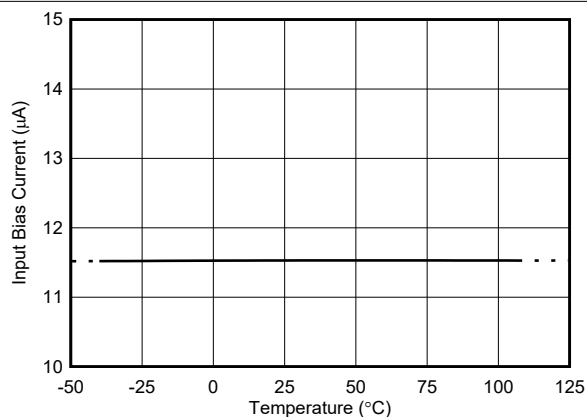


图 5-14. 输入偏置电流 ($I_{B^+} + I_{B^-}$) 与温度间的关系

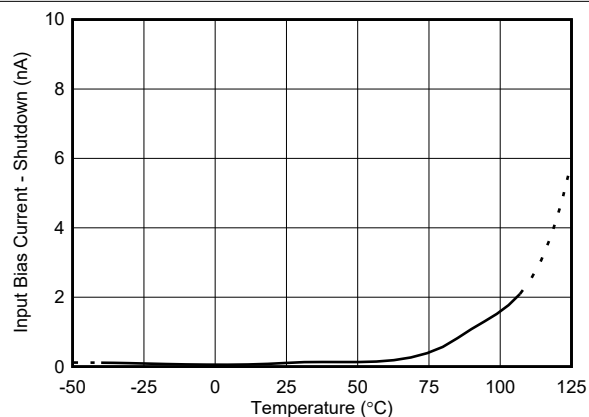


图 5-15. 输入偏置电流 ($I_{B^+} + I_{B^-}$) 与温度间的关系, 关断

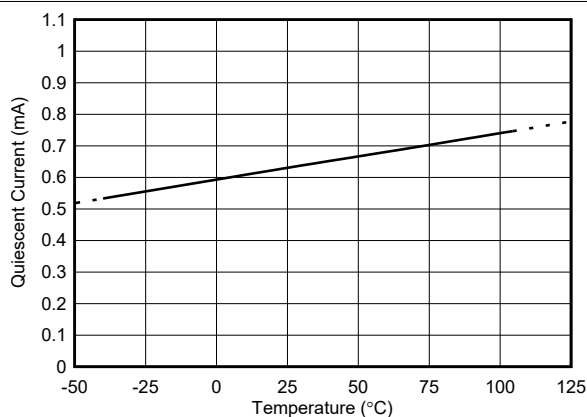


图 5-16. 静态电流与温度间的关系, 运行

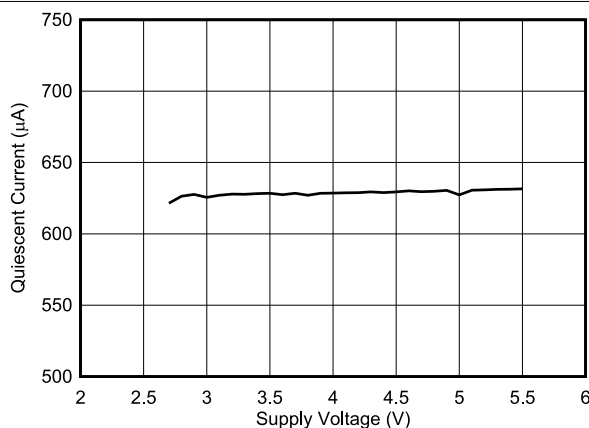


图 5-17. 静态电流与电源电压间的关系, 运行

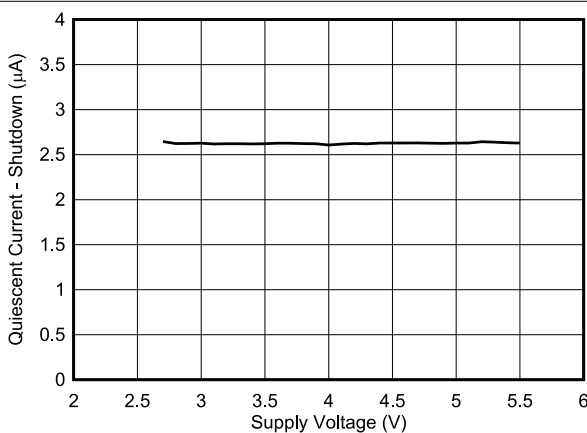


图 5-18. 关断 I_Q 与电源电压间的关系

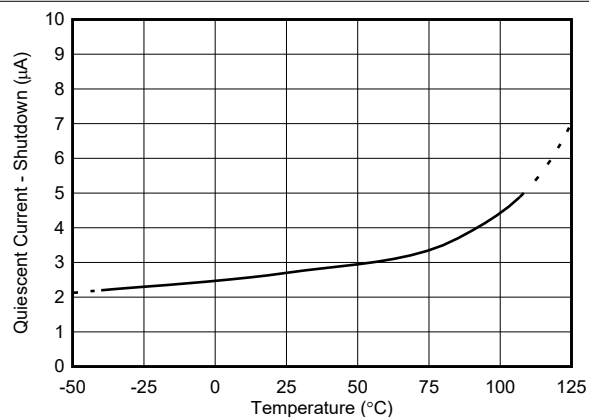


图 5-19. 静态电流与温度间的关系, 关断

5.8 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 12\text{V}$, $I_{SENSE} = 0\text{A}$ 和 $V_{VBUS} = 12\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)

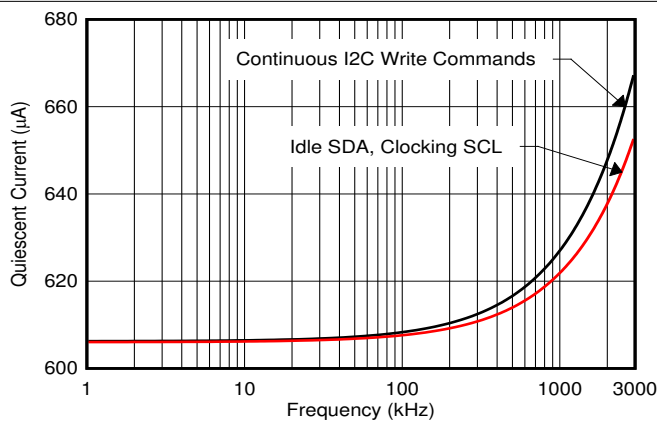


图 5-20. 静态电流与时钟频率间的关系, 运行

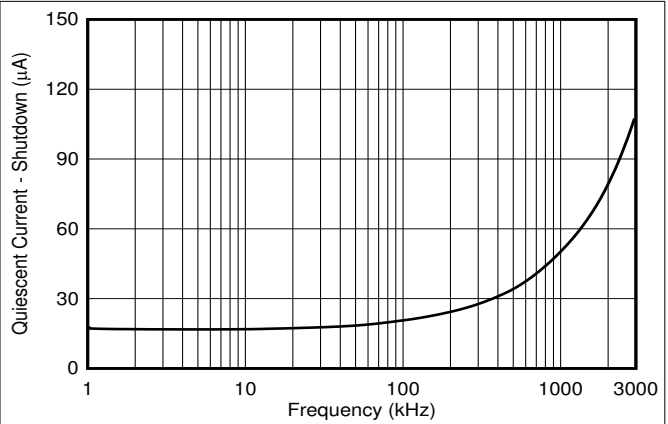


图 5-21. 静态电流与时钟频率间的关系, 关断

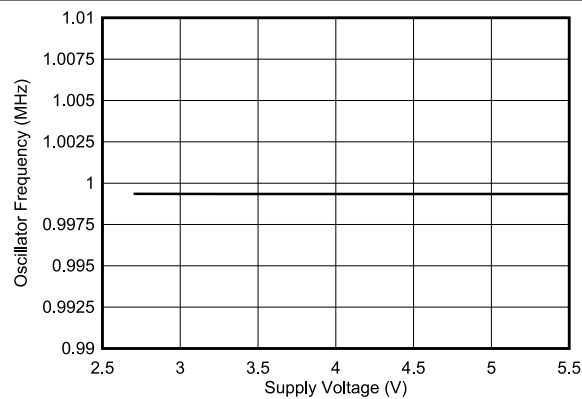


图 5-22. 内部时钟频率与电源间的关系

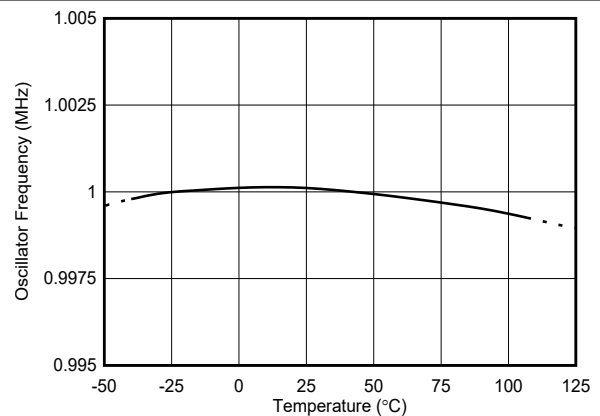


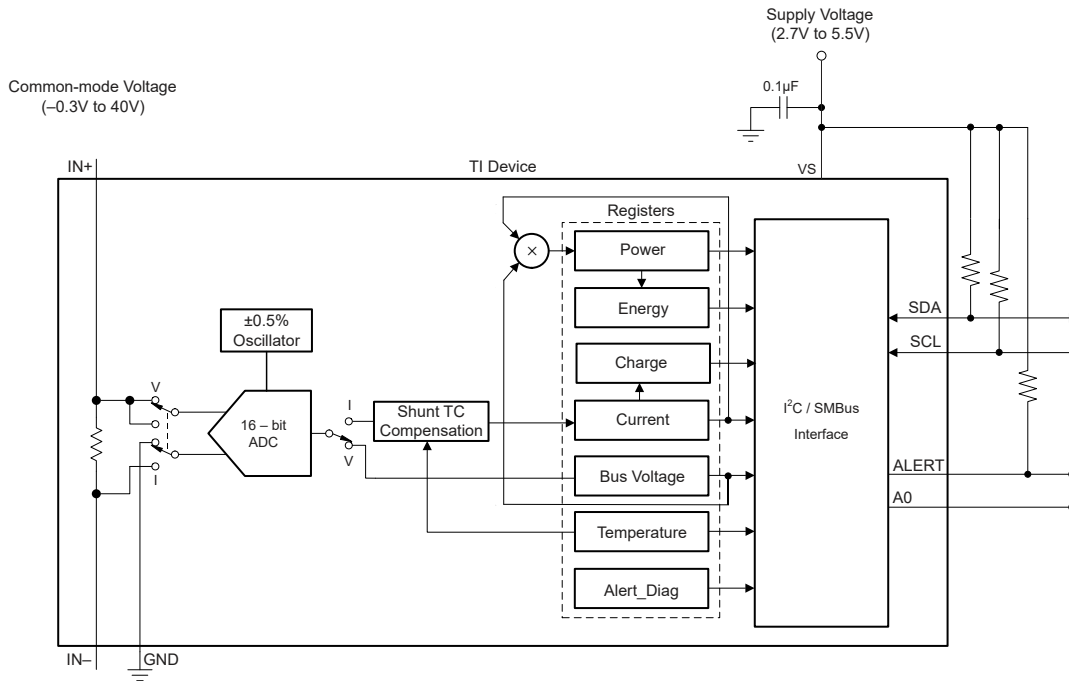
图 5-23. 内部时钟频率与温度间的关系

6 详细说明

6.1 概述

INA701 器件是一款具有 I²C 数字接口的数字电流检测放大器。该器件可以测量分流电压、总线电压和内部温度，同时计算在精密控制系统中进行准确决策所需的电流、功率、电能和电荷。可编程寄存器可进行灵活配置，从而确保测量精度以及连续或触发运行。有关详细的寄存器信息，请参阅[寄存器映射](#)。

6.2 功能方框图



6.3 特性说明

6.3.1 集成型分流电阻器

INA701 是一款精密低漂移数字电源监控器，可在 -40°C 至 $+105^{\circ}\text{C}$ 的整个额定环境温度范围内提供精确测量。集成型电流检测电阻器经过内部补偿，可在整个温度范围内提供测量稳定性，同时简化印刷电路板 (PCB) 布局布线和尺寸限制。图 6-2 展示了器件增益误差与电流间的函数关系。

IN+ 和 IN- 引脚可用于访问片上电流检测电阻器。该电阻器具有经过工厂校准和温度补偿的内部检测连接，可实现高精度。INA701 经过系统校准，可使电流检测电阻器和电流检测放大器彼此精确匹配。

从 IN+ 到 IN- 的标称引脚间电阻约为 $7\text{m}\Omega$ ，而数字电源监控器的内部电阻标称值为 $5\text{m}\Omega$ 。系统和封装的功率耗散要求基于 IN+ 和 IN- 引脚之间的总封装电阻。内部分流器的材料成分具有会随温度的升高而增加的电阻，如图 6-1 所示。

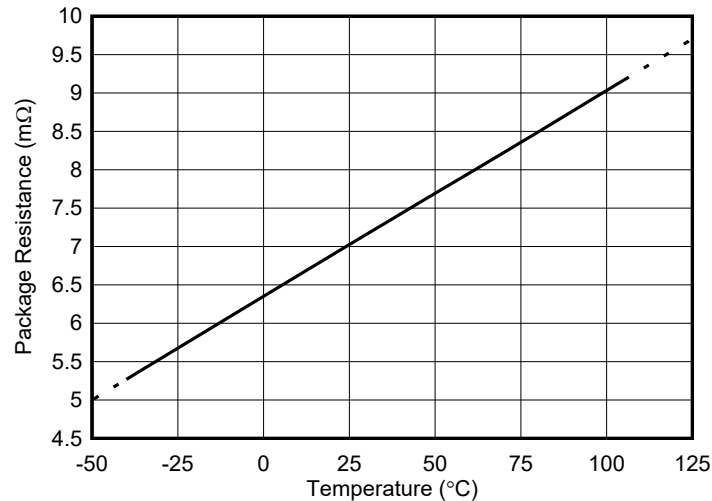


图 6-1. IN+ 至 IN - 封装电阻与温度间的关系

INA701 的内部补偿针对引脚到引脚电阻随温度升高而增加的情况进行校正，从而在环境温度范围内实现低于 50ppm/°C 的温漂。

INA701 在测量 0.1A 至 3A 范围内的电流时最精确。随着电流增大，电流测量误差也会增大。下面的图 6-2 显示了在 0.1A 至 2.5A 的分流电流范围内，INA701 的增益误差如何保持在 0.4% 以下。

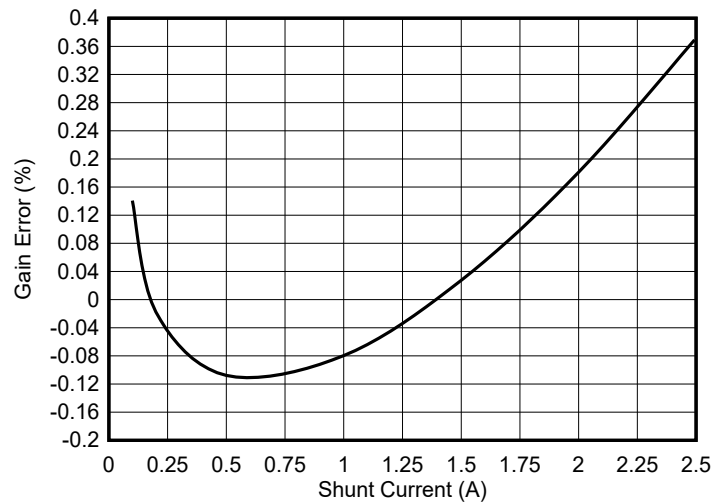


图 6-2. 增益误差与分流电流间的关系

增益误差的变化在各个器件之间始终保持一致，根据分流电流的不同，可以放大或缩小返回值，以提供更准确的结果。例如，为了在测量 5A 左右的电流时获得更高的精度，返回值可以按比例缩小约 2%，如图 6-3 所示。

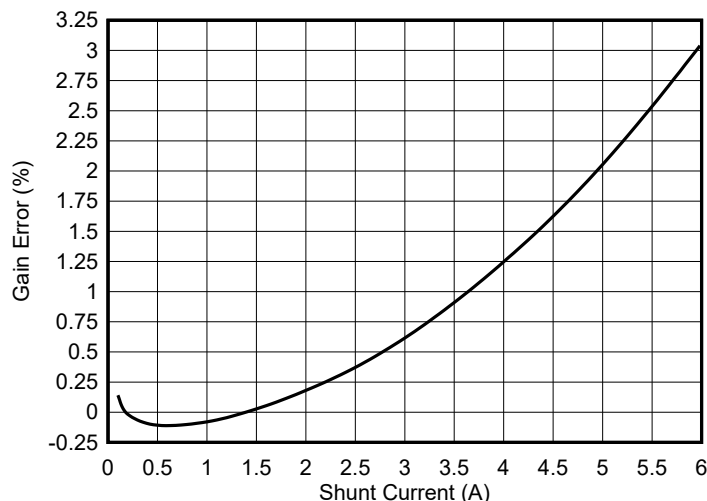


图 6-3. 增益误差与分流电流间的关系 (全范围)

6.3.2 安全工作区

器件耗散的功率会限制器件可以安全处理的最大电流。为器件供电的电流很小，因此主要热源是流经内部分流电阻器的电流。图 6-4 中所示的最大安全工作电流电平旨在确保封装中产生的热量受到限制，以及使器件的内部结温不超过 125°C。该数据是从评估模块中收集的，该评估模块使用一个 2 层电路板，其中 INA701 IN+ 和 IN- 引脚具有 1oz 铜电源平面。

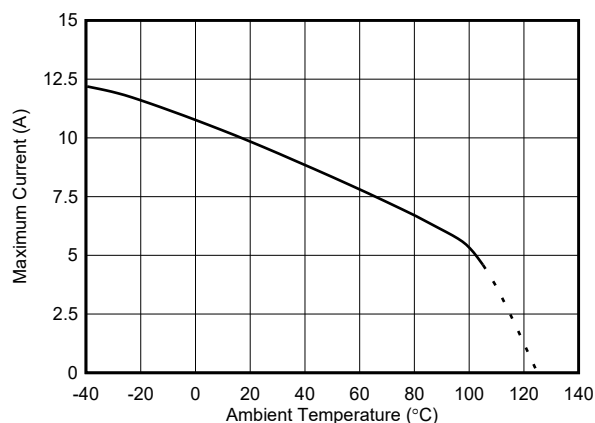


图 6-4. 最大分流电流与温度间的关系

小心

INA701 的最大结温为 125°C，不得超过该值。在 125°C 以上运行可能会对器件造成永久损坏。

尽管分流器可以承受高于 6A 的脉冲电流，但电流测量能力受限于 ADC 的 6.225A 满量程范围。

在具有过流瞬态的应用中，过流事件的峰值振幅和持续时间对于确定器件发热非常重要。图 6-5 展示了在超过 125°C 的最高结温之前器件可以承受的峰值脉冲电流与脉冲持续时间之间的关系。此曲线中显示的数据是使用 INA701 评估模块在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时收集的。

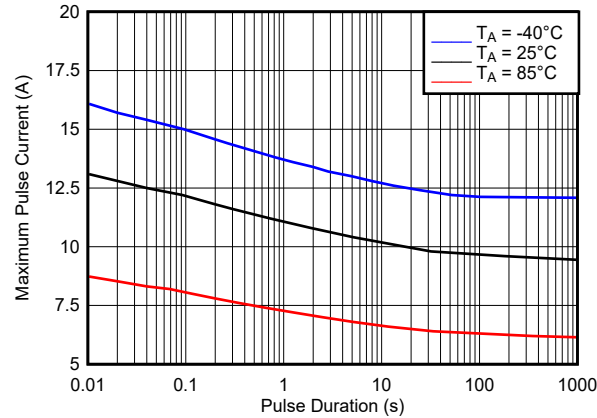


图 6-5. 最大脉冲电流与脉冲持续时间间的关系（单次事件）

6.3.3 多功能测量功能

尽管 INA701 的工作电源电压为 2.7V 至 5.5V，但它能够测量高达 40V 的电源轨上的电压和电流。测量电流的方式是：检测 IN+ 与 IN- 引脚之间内部分流电阻器的两端电压降。INA701 的输入级设计为输入共模电压可以高于器件电源电压 V_S 。输入引脚上支持的 -0.3V 至 +40V 共模电压范围适用于高侧和低侧电流测量。共模输入范围和器件电源电压互相独立，因而无需专门考虑电源时序；因此，总线电压与电源电压可在对方关闭时存在，而不会损坏器件。

该器件还通过 IN- 引脚测量总线电源电压，并通过集成的温度传感器测量温度。差分分流电压在 IN+ 和 IN- 引脚之间进行测量，而总线电压以器件接地为基准进行测量。监测的总线电压范围可以为 0V 至 40V，而监测的温度范围可以为 -40°C 至 +125°C。

分流电压、总线电压和温度测量值在内部多路复用到单个 ADC，如图 6-6 所示。

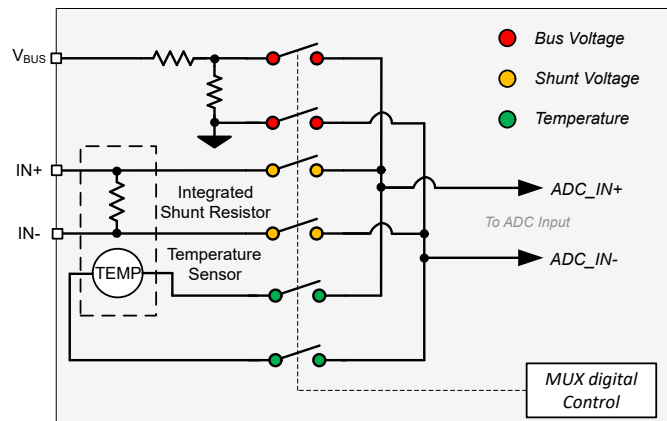


图 6-6. 高压输入多路复用器

6.3.4 内部测量和计算引擎

电流和电荷在测量温度和分流电压后计算，而功率和电能在测量总线电压后计算。功率和电能的计算基于之前的电流计算和更新的总线电压测量值。

当平均值的数量设置为 1 时，电流、电压和温度值为中间结果（请参阅图 6-7）。然而，当使用平均值计算时，每个 ADC 测量值都是一个中间结果，存储在相应的平均值计算寄存器中。在每个 ADC 样本之后，新计算出的电流、电压和温度值将附加到相应的平均值计算寄存器中，直到达到设定的平均值数量。测量所有样本后，确定平均电流和电压，计算功率，并将结果加载到相应的输出寄存器中，然后在这里读取结果。

电能值和电荷值在每个转换循环中累积。所以，INA701 平均值计算功能不适用于这些值。

功率、电荷和电能的计算在后台执行，不会增加总转换时间。

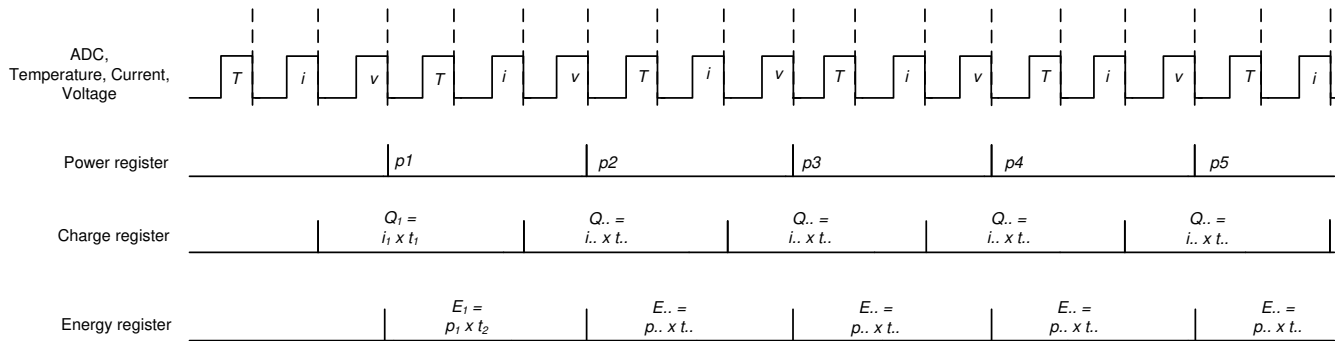


图 6-7. 功率、电能和电荷计算方案

6.3.5 高精度 Δ - Σ ADC

该集成式 ADC 是一款高性能、低失调电压、低温漂 Δ - Σ ADC，旨在支持双向电流。可通过连接至 ADC 输入的高压输入多路复用器来选择测量的输入，如图 6-6 所示。ADC 架构可实现较低的温漂测量值，并可在共模电压、温度和电源电压范围内实现一致的偏移测量。在电流检测应用中，优先选择低偏移 ADC 以提供近 0V 的偏移电压，从而最大限度地扩大系统的有用动态范围。

INA701 可以测量内核温度、电流和总线电压。每次电流测量之前都会进行内部温度测量。然后会对电流测量进行温度补偿，以实现低漂移性能。ADC_CONFIG 寄存器中的 MODE 位可通过选择模式以便只转换电流或总线电压，从而支持用户配置监控功能来满足特定的应用要求。如果未选择均值计算，则 ADC 转换完成后，转换后的值将在相应的寄存器中独立更新，这些值在转换结束时可通过数字接口读取。分流电压、总线电压和温度输入的转换时间在 50 μ s 到 4.12ms 之间独立设置，具体取决于在 ADC_CONFIG 寄存器中编程的值。电流值在温度和分流电压测量完成后计算得出。获得电流测量值的总时间是这两个参数的转换时间之和。启用的测量输入按顺序转换，这意味着转换所有输入的总时间取决于每个输入的转换时间和启用的输入数量。当使用均值计算时，中间值随后存储在均值计算累加器中，并且转换序列会重复执行，直到达到平均值的数量为止。在所有均值计算完成后，最终值会在相应的寄存器中进行更新，随后可供读取。这些值将保存在数据输出寄存器中，直到这些值被下一个完全完成的转换结果所取代。在这种情况下，对数据输出寄存器的读取不会影响正在进行中的转换。

ADC 有两种转换模式（连续和触发），可通过 ADC_CONFIG 寄存器中的 MODE 位来设置。在连续转换模式下，ADC 连续转换输入测量值，并在无限循环中更新输出寄存器，如上所述。在触发转换模式下，ADC 将如上所述转换输入测量值，之后 ADC 会进入关断模式，直到用户写入 MODE 位来生成另一个单冲触发。写入 MODE 位将中断并重新启动正在进行的触发转换或连续转换。虽然可随时读取此器件，并且来自上次转换的数据仍可用，但提供了转换就绪标志（ALERT_DIAG 寄存器中的 CNVRF 位）以帮助协调触发转换。这个位在所有转换和均值计算完成后设定。

在以下情况下，将清除转换就绪标志 (CNVRF)：

- 写入 ADC_CONFIG 寄存器（选择关断模式除外）；或者
- 读取 ALERT_DIAG 寄存器

当 INA701 器件用于任一转换模式时，专用数字引擎用于计算电流、功率、电荷和电能值（在后台）（请参阅[内部测量和计算引擎](#)）。在触发模式下，累积寄存器（ENERGY 和 CHARGE）无效，因为器件无法跟踪经过的时间。对于需要对电能和电荷测量累积时间进行关键测量的应用，必须将器件配置为使用连续转换模式，因为累积结果会不断更新，并且可以提供系统中电荷和电能消耗的真实系统表示。所有计算都在后台执行，不影响转换时间。

对于必须与系统中其他元件同步的应用，可以通过在 0ms（无延迟）到 510ms 范围内对 CONFIG 寄存器中的 CONVDLY 位进行编程来延迟 INA701 转换。对转换延迟进行编程的分辨率为 2ms。默认情况下，转换延迟设置为 0。当多个外部器件用于电压或电流监测时，转换延迟有助于进行测量同步。在需要同时进行电压和电流测量的

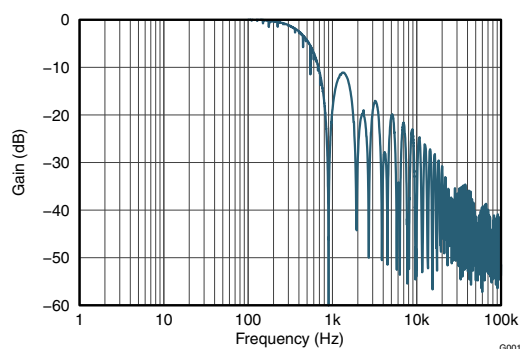
应用中，可延迟两个器件的电流测量，以便使外部电压和电流测量大致同时进行。请记住，即使 ADC 的内部时基是精确的，但内部和外部时基不匹配也会导致同步性随着时间推移而丧失。

6.3.5.1 低延迟数字滤波器

该器件集成了一个低通数字滤波器，它对 ADC 输出数据执行抽取和滤波，这有助于降低噪声。该数字滤波器根据不同输出数据速率自动调节，始终可在一个转换周期内达到稳定状态。用户可以灵活地选择不同的输出转换时间段 T_{CT} （从 $50\mu s$ 到 $4.12ms$ ）。在这种配置下，第一个振幅陷波出现在输出信号的奈奎斯特频率处，该频率由所选转换时间段确定（请参阅[方程式 1](#)）。

$$f_{NOTCH} = \frac{1}{2 \times T_{CT}} \quad (1)$$

这意味着滤波器截止频率按所述的数据输出速率成比例变化。[图 6-8](#) 展示了选择 $1.052ms$ 转换时间段时的滤波器响应。



转换时间 = $1.052ms$ ，仅单一转换

图 6-8. ADC 频率响应

6.3.5.2 灵活的转换时间和均值计算

分流电压、总线电压和温度的 ADC 转换时间可独立设置为 $50\mu s$ 到 $4.12ms$ 之间。转换时间的灵活性允许在各种噪声环境中进行稳健的操作。该器件还允许可编程的平均值计算时间介于单次转换直至平均 1024 次转换之间。所选的平均值计算量均匀地应用于所有有效的测量输入。[表 6-6](#) 中所示的 ADC_CONFIG 寄存器显示了有关受支持转换时间和平均值计算模式的更多详细信息。通过增加转换时间和平均值数量，可以提高 INA701 的 ADC 有效分辨率。[图 6-9](#) 和 [图 6-10](#) 展示了转换时间和均值计算对恒定输入信号的影响。

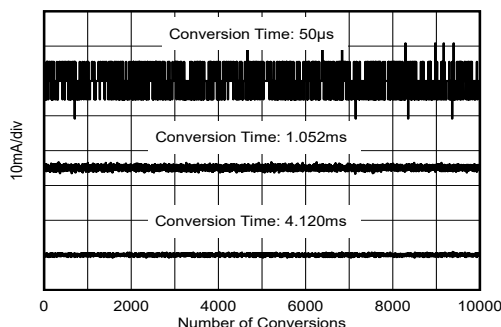


图 6-9. 噪声与转换时间间的关系（均值计算 = 1）

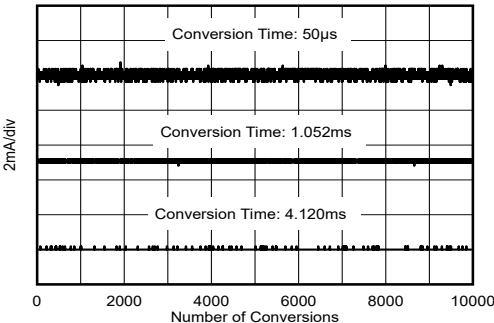


图 6-10. 噪声与转换时间间的关系 (均值计算 = 128)

转换时间和平均转换次数的设置会影响有效的测量分辨率。有关均值计算如何减少噪声和增加有效位数 (ENOB) 的更多详细信息，请参阅 [ADC 输出数据速率和噪声性能](#)。

6.3.6 集成精密振荡器

器件的内部时基由一个内部振荡器提供，该振荡器在室温下修整至低于 0.5% 的容差。精密振荡器是 ADC 转换的时钟源，以及用于计算能量和电荷的时间计数。数字滤波器响应随转换时间变化；因此，精确的时钟可确保滤波器响应和陷波频率在整个温度范围内保持一致。上电后，内部振荡器和 ADC 大约需要 300µs 才能达到 <1% 的误差稳定性。在时钟稳定后，ADC 数据输出将精确到 [规格](#) 中提供的电气规格。

6.3.7 多警报监控和故障检测

INA701 包括一个通用型开漏 ALERT 输出引脚，此引脚可用于报告多个诊断，或当器件在触发和连续转换模式下运行时，用于指示 ADC 转换完成。[表 6-1](#) 中所列的诊断受到持续监控，只要受监控的输出值超过其相关的超出范围阈值，就会通过 ALERT 引脚报告这些诊断。

表 6-1. ALERT 诊断说明

INA701 诊断	ALERT_DIAG 寄存器中的状态位 (只读)	超出范围阈值寄存器 (R/W)	寄存器默认值
电流欠限	CURRENTUL	CUL	0x8000 h (二进制补码)
电流超限	CURRENTOL	COL	0x7FFF h (二进制补码)
总线电压高于上限	BUSOL	BOVL	0x7FFF h (二进制补码，仅限正值)
总线电压低于下限	BUSUL	BUVL	0x0000 h (二进制补码，仅限正值)
温度高于上限	TMPOL	TEMP_LIMIT	0xFFFF h (二进制补码，仅限正值)
功率高于上限	POL	PWR_LIMIT	0x7FFF h (二进制补码)

读取 ALERT_DIAG 寄存器用于确定哪个诊断触发了 ALERT 引脚。该寄存器如[表 6-13](#) 所示，还用于监控其他相关诊断并配置一些 ALERT 引脚功能。

- 警报锁存使能 — 如果触发了 ALERT 引脚，即使所有诊断条件都已清除后，此功能仍将保持引脚的值。读取 ALERT_DIAG 寄存器将复位 ALERT 引脚的状态。可以通过设置 ALATCH 位启用此功能。
- 转换就绪使能 — 当 ADC 转换已完成且输出值已可供通过数字接口读取时，使 ALERT 引脚置位。可以通过设置 CNVR 位启用此功能。也可以通过 CNVRF 位读取转换已完成事件，而无论 CNVR 位设置如何。

- 平均输出上的警报比较 - 允许将超出范围阈值与 ADC 生成的平均数据值进行比较。当与超出范围阈值比较时，这有助于从输出数据中消除噪声，以避免由噪声导致的错误警报。但是，由于平均值计算需要花费一定的时间，诊断将延迟。可以通过设置 **SLOWALERT** 位启用此功能。
- 警报极性 - 允许器件反转 **ALERT** 引脚的活动状态。请注意，**ALERT** 引脚是一个开漏输出，必须通过电阻器上拉。默认情况下，**ALERT** 引脚处于低电平有效状态，可以使用 **APOL** 控制位将其配置为实现高电平有效功能。

ALERT 引脚未报告但可通过读取 **ALERT_DIAG** 寄存器获得的其他诊断功能：

- 数学溢出 - 由 **MATHOF** 位表示，当算术运算导致内部寄存器溢出时报告。
- 存储器状态 - 由 **MEMSTAT** 位指示，监控器件非易失性修整存储器的运行状况。当器件正常运行时，该位必须始终读数为“1”。
- 电能溢出 - 由 **ENERGYOF** 位表示，当 **ENERGY** 寄存器由于数据累积而达到溢出状态时报告。
- 电荷溢出 - 由 **CHARGEOF** 位表示，当 **CHARGE** 寄存器由于数据累积而达到溢出状态时报告。

当 **ALERT** 引脚配置为报告 ADC 转换完成事件时，**ALERT** 引脚成为通用的报告输出。图 6-11 展示了一个示例，其中器件报告 ADC 转换完成事件，而 **INA701** 器件会受到过流、总线欠压、过温和过功率事件的影响。

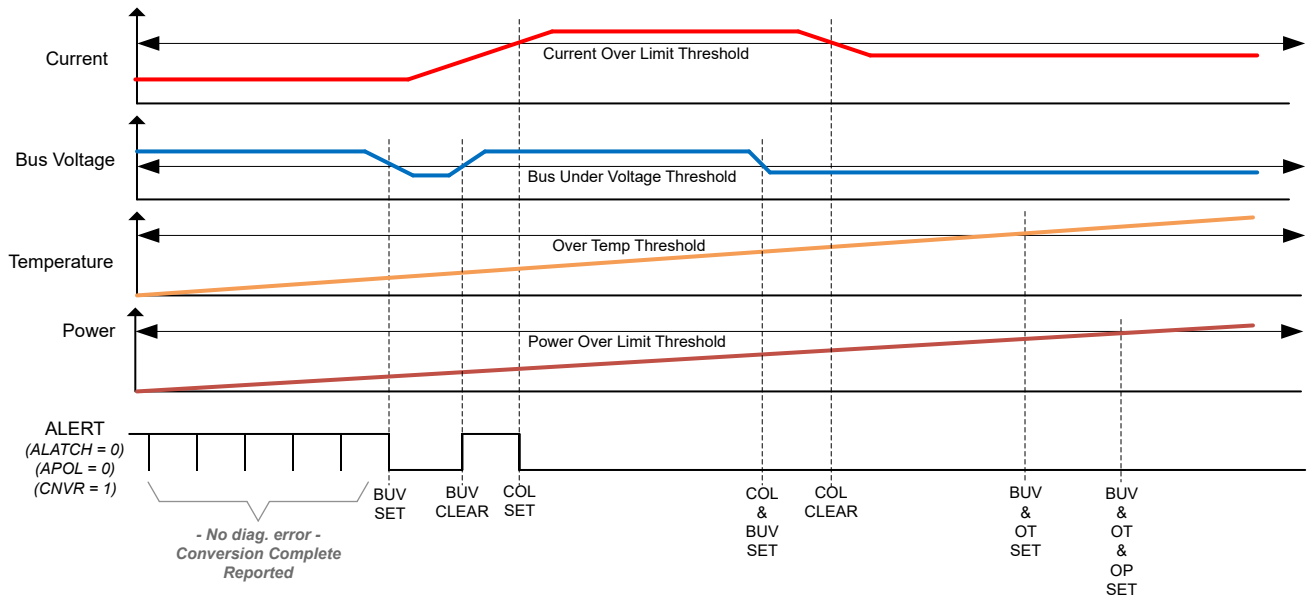


图 6-11. 多警报配置

6.4 器件功能模式

6.4.1 关断模式

除了两个转换模式（持续和触发）之外，此器件还有一个关断模式（通过 **ADC_CONFIG** 寄存器中的 **MODE** 位选择），此模式将静态电流降低到 **5μA** 以下，并关闭进入器件输入端的电流，这样就减少了器件未使用时漏电源产生的影响。当器件处于关断模式时，可以写入和读取器件的寄存器。器件保持在关断模式，直到收到另一个触发转换命令或连续转换命令。

在关断模式下，可以触发器件以执行转换。触发转换时，**ADC** 开始转换。转换完成后，器件将返回到关断状态。

请注意，关断电流由处于非工作状态的通信总线指定。处于工作状态的时钟和数据活动随总线频率的增加而增加电流消耗，。

6.4.2 上电复位

当 V_S 降至低于 1.26V (典型) 时, 所有寄存器复位为默认值, 此时上电复位 (POR) 置为有效。可以通过在 CONFIG 寄存器中设置 RST 位来启动手动器件复位。默认上电寄存器值显示在每个寄存器描述的复位列中。有关寄存器说明, 请参阅 [寄存器映射](#)。

6.5 编程

6.5.1 I²C 串行接口

INA701 在 SMBus 和 I²C 接口上均仅作为辅助器件运行。通过开漏 SDA 和 SCL 线路实现到总线的连接。SDA 和 SCL 引脚特有的集成式峰值抑制滤波器和施密特触发器可大大减少输入峰值和总线噪声的影响。尽管此器件将峰值抑制功能集成到数字 I/O 线路中，但采用适当的布局技术有助于更大限度地减少进入通信线路的耦合量。这个引入的噪声会从两条通信线路本身之间的电容耦合信号边沿或者从其他出现在系统中的开关噪声源产生。在一个印刷电路板 (PCB) 上两层之间与接地并联的路由走线通常能减少通信线路间的耦合效应。将通信线路屏蔽可减小耦合进入数字 I/O 线路的有害噪声被错误地解释为开始或停止命令的可能性。

INA701 支持针对快速模式 (1kHz 至 400kHz) 和高速模式 (1kHz 至 2.94MHz) 的传输协议。对于所有数据字节，首先传输最高有效字节 (MSB)，并遵循 SMBus 3.0 传输协议。

为了与 INA701 进行通信，主器件必须首先通过一个辅助器件地址字节来寻找辅助器件的地址。辅助器件地址字节包括 7 个地址位和 1 个方向位，这个方向位表明是执行读取还是写入操作。

该器件具有单个地址引脚 A0。表 6-2 列出了四个可能地址中每一个地址的引脚逻辑电平。该器件在每个总线通信上对该地址引脚的状态进行采样。在接口上发生任何活动之前确定引脚状态。

表 6-2. 地址引脚和辅助器件地址

A0	器件地址
GND	1010100
VS	1010101
SDA	1010110
SCL	1010111

备注

当将 A0 引脚连接到 SDA 以设置器件地址时，I²C 地址的 MSB 上需要额外的 100ns 保持时间，以为器件提供正确的寻址。

6.5.1.1 通过 I²C 串行接口写入和读取

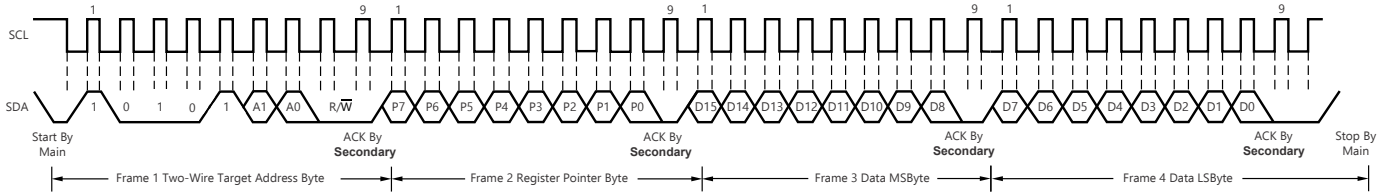
通过向 INA701 上特定寄存器的指针写入适当的值，可实现对该寄存器的访问。有关寄存器和对应地址的完整列表，请参阅 [寄存器映射](#)。寄存器指针的值 (如图 6-14 所示) 是在 $\overline{R/\overline{W}}$ 位为低电平的辅助器件地址字节之后被传输的第一个字节。对此器件的每次写入操作都需要一个寄存器指针值。

写入寄存器的过程从主器件传输的第一个字节开始。这个字节为辅助器件地址，其中 $\overline{R/\overline{W}}$ 位为低电平。然后，器件确认接收到一个有效地址。主器件传输的下一个字节是要访问的寄存器的地址。此寄存器地址值将寄存器指针更新为指向所需的内部器件寄存器。下两个字节被写入由寄存器指针进行寻址的寄存器。器件确认收到每个数据字节。主器件可以通过生成开始或停止条件来结束数据传输。

从器件读取时，写入操作存储在寄存器指针中的最后一个值确定在读取操作期间应该读取哪一个寄存器。为了将寄存器指针更改为进行读取操作，必须在寄存器指针中写入一个新值。此写入操作是通过发出一个辅助器件地址字节 (其中， $\overline{R/\overline{W}}$ 位为低电平) 后跟寄存器指针字节来实现的。无需额外的数据。然后，主器件会生成开始条件并发送辅助器件的地址字节 (其中 $\overline{R/\overline{W}}$ 位为高电平)，以此来启动读取命令。辅助器件传输下一个字节，这个字节是寄存器指针指示的寄存器的最高有效字节。这个字节后跟一个来自主器件的 *确认*；然后辅助器件会传输最低有效字节 (LSB)。主器件不一定会确认收到第二个数据字节。主器件可通过在接收任何数据字节之后生成 *不确认*，或者生成开始或停止条件来结束数据传输。如果需要从同一寄存器执行重复的读取操作，则无需连续发送寄存器指针字节。器件会保留寄存器指针值，直到下一次写入操作更改该值为止。

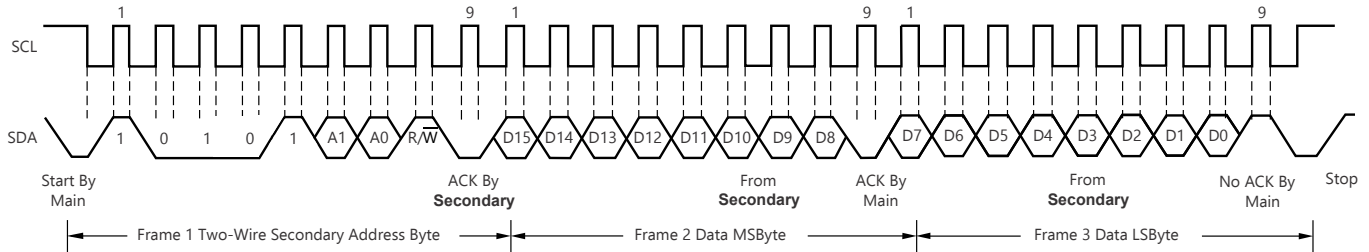
图 6-12 展示了写入操作时序图。图 6-13 展示了读取操作时序图。下图显示了对 16 位寄存器的读取和写入操作。

首先发送的寄存器字节为最高有效字节，之后是最低有效字节。



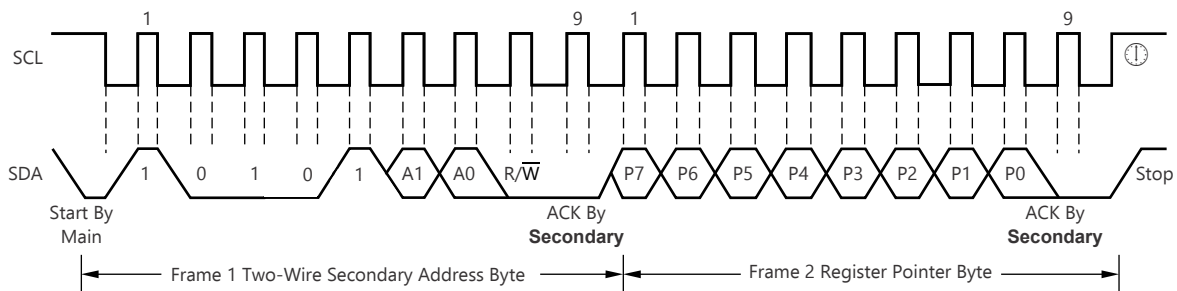
- 通过 A0 地址引脚的设置可确定辅助器件地址字节的值。请参阅表 6-2。
- 此器件不支持数据包错误检查 (PEC)，也不执行时钟扩展。

图 6-12. 写入字格式的时序图



- 通过 A0 地址引脚的设置可确定辅助器件地址字节的值。请参阅表 6-2。
- 从最后寄存器指针位置开始读取数据。如果需要一个全新的寄存器，必须更新寄存器指针。请参阅图 6-14。
- 也可以由主器件发送 ACK。
- 此器件不支持数据包错误检查 (PEC)，也不执行时钟扩展。

图 6-13. 读取字格式的时序图



- 通过 A0 地址引脚的设置可确定辅助器件地址字节的值。请参阅表 6-2。

图 6-14. 典型寄存器指针设定

6.5.1.2 高速 I²C 模式

当总线空闲时，SDA 和 SCL 线路都被上拉电阻拉至高电平。主器件生成一个开始条件，随后是一个有效的串行字节，其中包含高速 (HS) 主器件代码 00001XXX。该传输在不高于 400kHz 的快速 (400kHz) 模式和标准 (100kHz) (F/S) 模式上进行。该器件不对 HS 主器件代码进行确认，但的确会识别此代码并切换器件内部滤波器以支持 2.94MHz 运行。

然后，主器件生成重复的开始条件（重复的开始条件具有与开始条件相同的时序）。在这个重复的启动条件之后，协议与 F/S 模式一致，除非允许的传输速度高达 2.94 MHz。不要使用停止条件，而是使用重复的启动条件将总线保持在 HS 模式。停止条件结束 HS 模式并切换器件的所有滤波器以支持 F/S 模式。

6.5.1.3 SMBus 警报响应

INA701 设计为响应 SMBus 警报响应地址。SMBus 警报响应为简单的辅助器件提供快速故障识别。当警报出现时，主器件可以广播警报响应辅助器件地址 (0001 100) ($\overline{R\overline{W}}$ 位设为高电平)。在此警报响应之后，任何生成警报的辅助器件都会通过确认警报响应并在总线上发送器件地址来标识其自身。

警报响应能够同时激活几个不同的目标器件，这一点与 I²C 通用广播相似。如果多于一个目标器件试图进行响应，那么采用总线仲裁规则。在仲裁中失败的器件不会生成确认，在该器件赢得仲裁前会继续将警报线路保持为低电平。

6.6 寄存器映射

6.6.1 INA701 寄存器

表 6-3 列出了 INA701 寄存器。表 6-3 中未列出的所有寄存器位置都应视为保留的位置，并且不得修改寄存器内容。

表 6-3. INA701 寄存器

地址	首字母缩写词	寄存器名称	寄存器大小 (位)	部分
0h	CONFIG	配置	16	转到
1h	ADC_CONFIG	ADC 配置	16	转到
5h	VBUS	总线电压测量	16	转到
6h	DIETEMP	温度测量	16	转到
7h	电流	电流结果	16	转到
8h	POWER	功率结果	24	转到
9h	ENERGY	电能结果	40	转到
Ah	电荷	电荷结果	40	转到
Bh	ALERT_DIAG	诊断标志和警报	16	转到
Ch	COL	电流超限阈值	16	转到
Dh	CUL	电流欠限阈值	16	转到
Eh	BOVL	总线过压阈值	16	转到
Fh	BUVL	总线欠压阈值	16	转到
10h	TEMP_LIMIT	温度高于上限阈值	16	转到
11h	PWR_LIMIT	功率高于上限阈值	16	转到
3Eh	MANUFACTURER_ID	制造商 ID	16	转到

复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 6-4 展示了适用于此部分中访问类型的代码。

表 6-4. INA701 访问类型代码

访问类型	代码	说明
读取类型		
R	R	值只能读取
写入类型		
W	W	值只能写入
读取或写入类型		
R/W	R/W	值可以读取或写入

6.6.1.1 配置 (CONFIG) 寄存器 (地址 = 0h) [复位 = 0h]

CONFIG 寄存器如表 6-5 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-5. CONFIG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	RST	R/W	0h	复位位。将该位设置为“1”会生成一个与上电复位相同的系统复位。 将所有寄存器复位为默认值。 0h = 正常运行 1h = 系统复位将寄存器设置为默认值 该位会自行清除。
14	RSTACC	R/W	0h	将累积寄存器 ENERGY 和 CHARGE 的内容复位为 0 0h = 正常运行 1h = 将 ENERGY 和 CHARGE 寄存器清除为默认值
13-6	CONVDLY	R/W	0h	以 2ms 的步长设置初始 ADC 转换的延迟。 0h = 0s 1h = 2ms FFh = 510ms
5	RESERVED	R	0h	保留。始终读为 0。
4	RESERVED	R	1h	保留。始终读为 1。
3-0	RESERVED	R	0h	保留。始终读为 0。

6.6.1.2 ADC 配置 (ADC_CONFIG) 寄存器 (地址 = 1h) [复位 = FB68h]

ADC_CONFIG 寄存器如表 6-6 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-6. ADC_CONFIG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-12	模式	R/W	Fh	用户可以针对总线电压、电流或温度测量，设置 MODE 位以启用连续模式或触发模式。 0h = 关断 1h = 触发总线电压，单冲 2h = 保留 3h = 保留 4h = 触发温度，单冲 5h = 触发温度和总线电压，单冲 6h = 触发温度和电流，单冲 7h = 触发温度、电流和总线电压，单冲 8h = 关断 9h = 仅连续总线电压 Ah = 保留 Bh = 保留 Ch = 仅连续温度 Dh = 连续总线电压和温度 Eh = 连续温度和电流 Fh = 连续温度、电流和总线电压
11-9	VBUSCT	R/W	5h	设置总线电压测量的转换时间。 0h = 50μs 1h = 84μs 2h = 150μs 3h = 280μs 4h = 540μs 5h = 1052μs 6h = 2074μs 7h = 4120μs
8-6	VSENCT	R/W	5h	设置分流电阻器电压的转换时间。与温度转换时间结合使用。电流测量的总转换时间是 VSENCT 和 TCT 选择的总和。 0h = 50μs 1h = 84μs 2h = 150μs 3h = 280μs 4h = 540μs 5h = 1052μs 6h = 2074μs 7h = 4120μs

表 6-6. ADC_CONFIG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
5-3	TCT	R/W	5h	设置温度测量的转换时间。在电流测量期间与分流电压转换时间结合使用。电流测量的总转换时间是 VSENCT 和 TCT 选择的总和。 0h = 50μs 1h = 84μs 2h = 150μs 3h = 280μs 4h = 540μs 5h = 1052μs 6h = 2074μs 7h = 4120μs
2-0	AVG	R/W	0h	选择 ADC 样片平均计数。平均值计算设置适用于所有有效输入。当 >0h 时，将在平均值计算完成后更新输出寄存器。 0h = 1 1h = 4 2h = 16 3h = 64 4h = 128 5h = 256 6h = 512 7h = 1024

6.6.1.3 总线电压测量 (VBUS) 寄存器 (地址 = 5h) [复位 = 0h]

VBUS 寄存器如表 6-7 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-7. VBUS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	VBUS	R	0h	总线电压输出。二进制补码值，但始终为正。 转换因子：3.125mV/LSB

6.6.1.4 温度测量 (DIETEMP) 寄存器 (地址 = 6h) [复位 = 0h]

DIETEMP 寄存器如表 6-8 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-8. DIETEMP 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-4	DIETEMP	R	0h	内部芯片温度测量。二进制补码值。 转换因子：125m°C/LSB。
3-0	RESERVED	R	0h	保留。始终读为 0。

6.6.1.5 电流结果 (CURRENT) 寄存器 (地址 = 7h) [复位 = 0h]

CURRENT 寄存器如表 6-9 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-9. CURRENT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	电流	R	0h	计算得出的电流输出 (单位为安培)。二进制补码值。 转换因子：480 μ A/LSB。

6.6.1.6 功率结果 (POWER) 寄存器 (地址 = 8h) [复位 = 0h]

POWER 寄存器如表 6-10 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-10. POWER 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
23-0	POWER	R	0h	计算得出的功率输出。 输出值 (以瓦特为单位)。 无符号表示。正值。 转换因子：96 μ W/LSB。

6.6.1.7 电能结果 (ENERGY) 寄存器 (地址 = 9h) [复位 = 0h]

ENERGY 寄存器如表 6-11 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-11. ENERGY 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
39-0	ENERGY	R	0h	计算得出的电能输出。 输出值以焦耳为单位。无符号表示。正值。 转换因子：1.536mJ/LSB。

6.6.1.8 电荷结果 (CHARGE) 寄存器 (地址 = Ah) [复位 = 0h]

CHARGE 寄存器如表 6-12 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-12. CHARGE 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
39-0	电荷	R	0h	计算得出的电荷输出。输出值以库仑为单位。二进制补码值。 转换因子：30 μ C/LSB。

6.6.1.9 诊断标志和警报 (ALERT_DIAG) 寄存器 (地址 = Bh) [复位 = 0001h]

ALERT_DIAG 寄存器如表 6-13 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-13. ALERT_DIAG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	ALATCH	R/W	0h	当警报锁存使能位设置为透明模式时，如果故障已被清除，则 ALERT 引脚和标志位复位为空闲状态。 当警报锁存使能位设置为锁存模式时，Alert 引脚和 Alert 标志位在故障后保持有效，直到已读取 ALERT_DIAG 寄存器。 0h = 透明 1h = 锁存
14	CNVR	R/W	0h	将该位设置为高电平可配置在置位转换就绪标志 (位 1) 时要置位的 ALERT 引脚，指示转换周期已完成。 0h = 禁用 ALERT 引脚上的转换就绪标志 1h = 启用 ALERT 引脚上的转换就绪标志
13	SLOWALERT	R/W	0h	启用时，ALERT 功能置位为完成的平均值。 这样可以灵活地将 ALERT 延迟到平均值之后。 0h = 非平均 (ADC) 值上的 ALERT 比较 1h = 平均值上的 ALERT 比较
12	APOL	R/W	0h	警报极性位设定 ALERT 引脚极性。 0h = 正常 (低电平有效，开漏) 1h = 反相 (高电平有效，开漏)
11	ENERGYOF	R	0h	该位表示 ENERGY 寄存器的运行状况。 如果 40 位 ENERGY 寄存器已溢出，则该位设置为 1。 0h = 正常 1h = 溢出 通过置位配置寄存器中的 RSTACC 字段来清除。
10	CHARGEOF	R	0h	该位表示 CHARGE 寄存器的运行状况。 如果 40 位 CHARGE 寄存器已溢出，则该位设置为 1。 0h = 正常 1h = 溢出 通过置位配置寄存器中的 RSTACC 字段来清除。
9	MATHOF	R	0h	如果算术运算导致一个溢出错误的话，该位被置为 1。 该位表示电流和功率数据可能无效。 0h = 正常 1h = 溢出 必须通过触发另一个转换或通过使用 RSTACC 位清除累加器来手动清除。
8	RESERVED	R	0h	保留。始终读为 0。

表 6-13. ALERT_DIAG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
7	TMPOL	R	0h	如果温度测量值超过温度高于上限寄存器中的阈值, 则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 过热事件 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器清除该位。
6	CURRENTOL	R	0h	如果电流测量值超过电流超限寄存器中的阈值, 则该位设置为1。 0h = 正常 1h = 过流事件 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器清除该位。
5	CURRENTUL	R	0h	如果电流测量值低于分流欠限寄存器中的阈值, 则该位设置为1。 0h = 正常 1h = 欠流事件 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器清除该位。
4	BUSOL	R	0h	如果总线电压测量值超过总线电压高于上限寄存器中的阈值, 则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 总线电压高于上限事件 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器清除该位。
3	BUSUL	R	0h	如果总线电压测量值低于总线电压低于下限寄存器中的阈值, 则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 总线电压低于下限事件 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器清除该位。
2	POL	R	0h	如果功率测量值超过功率限制寄存器中的阈值, 则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 功率高于上限事件 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器清除该位。
1	CNVRF	R	0h	如果转换完成, 则该位设置为 1。 0h = 正常 1h = 转换完成 当 ALATCH=1 时, 通过读取该寄存器或启动新的触发转换来清除该位。
0	MEMSTAT	R	1h	如果在器件修整存储器空间中检测到校验和错误, 则该位设置为 0。 0h = 存储器校验和错误 1h = 正常运行

6.6.1.10 电流超限阈值 (COL) 寄存器 (地址 = Ch) [复位 = 7FFFh]

如果在该寄存器中输入负值，则电流测量值为 0A 会触发此警报。当对欠流和过流阈值使用负值时，请注意，过流阈值必须设置为这两个值中的较大值（即较小的负值）。COL 寄存器如表 6-14 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-14. COL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	COL	R/W	7FFFh	设置用于比较值的阈值，以检测过流情况（过流保护）。二进制补码值。

6.6.1.11 电流欠限阈值 (CUL) 寄存器 (地址 = Dh) [复位 = 8000h]

CUL 寄存器如表 6-15 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-15. CUL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	CUL	R/W	8000h	设置用于比较值的阈值，以检测欠流情况。二进制补码值。

6.6.1.12 总线过压阈值 (BOVL) 寄存器 (地址 = Eh) [复位 = 7FFFh]

BOVL 寄存器如表 6-16 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-16. BOVL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
14-0	BOVL	R/W	7FFFh	设置用于比较值的阈值，以检测总线过压（过压保护）。无符号表示，仅限正值。转换因子：3.125mV/LSB。

6.6.1.13 总线欠压阈值 (BUVL) 寄存器 (地址 = Fh) [复位 = 0h]

BUVL 寄存器如表 6-16 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-17. BUVL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
14-0	BUVL	R/W	0h	设置用于比较值的阈值，以检测总线欠压（欠压保护）。无符号表示，仅限正值。转换因子：3.125mV/LSB。

6.6.1.14 温度高于上限阈值 (TEMP_LIMIT) 寄存器 (地址 = 10h) [复位 = 7FFFh]

TEMP_LIMIT 寄存器如表 6-18 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-18. TEMP_LIMIT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	TOL	R/W	7FFFh	设置用于比较值的阈值，以检测过热测量值。二进制补码值。在此字段中输入的值直接与 DIETEMP 寄存器中的值进行比较，以确定是否存在过热情况。转换因子：7.8125m°C/LSB。

6.6.1.15 功率高于上限阈值 (PWR_LIMIT) 寄存器 (地址 = 11h) [复位 = FFFFh]

PWR_LIMIT 寄存器如表 6-19 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-19. PWR_LIMIT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	POL	R/W	FFFFh	设置用于比较值的阈值，以检测功率高于上限测量值。无符号表示，仅限正值。在此字段中输入的值直接与 POWER 寄存器中的值进行比较，以确定是否存在超出功率情况。转换因子：24.576mW/LSB。

6.6.1.16 制造商 ID (MANUFACTURER_ID) 寄存器 (地址 = 3Eh) [复位 = 5449h]

MANUFACTURER_ID 寄存器如表 6-20 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 6-20. MANUFACTURER_ID 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	MANFID	R	5449h	以 ASCII 格式读回 TI。

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

7.1 应用信息

7.1.1 器件测量范围和分辨率

表 7-1 展示了分流器、总线和温度测量的满量程电压及其相关的步长。

表 7-1. 寄存器满量程值和分辨率

参数	寄存器地址	尺寸	满量程值	分辨率
电流	7h	16 位，有符号	$\pm 6.2259\text{A}$	190 $\mu\text{A}/\text{LSB}$
总线电压	5h	16 位，有符号，始终为正	0V 至 40V	3.125mV/LSB
内核温度	6h	12 位，有符号	-40°C 至 +150°C	125m°C/LSB
电源	8h	24 位，无符号	0.63534kW	38 $\mu\text{W}/\text{LSB}$
电能	9h	40 位，无符号	668.5MJ	0.608mJ/LSB
电荷	Ah	40 位，有符号	6.52835MC	11.875 $\mu\text{C}/\text{LSB}$

内部芯片温度传感器范围介于 -256°C 至 +256°C 之间，但受 -40°C 至 125°C 结温范围的限制。同样，总线电压测量范围高达 102.4V，但受器件限制为 40V。

电流、总线电压、温度、功率、电能和电荷测量值可以通过相应的地址寄存器来读取。这些值通过返回值乘以相应的 LSB 大小来计算。

有符号值以二进制补码格式表示。

溢出后，ENERGY 寄存器将滚动并从零开始。通过在 CONFIG 寄存器中设置 RSTACC 位，也可以随时复位此寄存器值。

CHARGEOF 位指示 CHARGE 寄存器中的溢出事件。如果发生溢出情况，则必须通过将 CONFIG 寄存器中的 RSTACC 位置位来手动复位 CHARGE 寄存器。

有关使用这些公式的设计示例，请参阅 [详细设计过程](#)。

7.1.2 ADC 输出数据速率和噪声性能

INA701 的噪声性能和有效分辨率取决于 ADC 转换时间。该器件还支持数字均值计算功能，有助于进一步降低数字噪声。此器件可选择 ADC 转换时间和数据平均值计算功能，这种灵活性提高了信噪比，并以更低的偏移量实现更高的动态范围。较低信号电平下的噪声分布主要由系统噪声控制，而系统噪声主要由 1/f 噪声或白噪声组成。通过增加转换时间和平均值数量，可以提高 INA701 的 ADC 有效分辨率。

表 7-2 展示了器件支持的输出数据速率转换设置。最快的转换设置为 50 μs 。典型的无噪声分辨率表示为基于器件测量数据的有效位数 (ENOB)。ENOB 是根据噪声峰峰值计算的，这可考虑完整的噪声分布。温度测量的转换时间设置为上电默认值。

表 7-2. INA701 噪声性能

ADC 转换时间周期 [μs]	输出采样平均值计算 [采样量]	输出采样周期 [ms]	无噪声 ENOB 电流测量
50	1	0.05	9.28
84		0.084	9.85
150		0.15	10.32
280		0.28	10.80
540		0.54	11.12
1052		1.052	11.90
2074		2.074	12.25
4120		4.12	12.54
50	4	0.2	10.01
84		0.336	10.46
150		0.6	11.39
280		1.12	11.71
540		2.16	12.39
1052		4.208	12.71
2074		8.296	13.39
4120		16.48	13.71
50	16	0.8	11.07
84		1.344	11.71
150		2.4	12.39
280		4.48	12.90
540		8.64	13.39
1052		16.832	13.71
2074		33.184	14.71
4120		65.92	14.71
50	64	3.2	11.90
84		5.376	12.90
150		9.6	13.39
280		17.92	13.71
540		34.56	14.12
1052		67.328	14.71
2074		132.736	15.71
4120		263.68	15.71
50	128	6.4	12.90
84		10.752	13.12
150		19.2	13.39
280		35.84	14.71
540		69.12	14.71
1052		134.656	15.71
2074		265.472	15.71
4120		527.36	15.71

表 7-2. INA701 噪声性能 (续)

ADC 转换时间周期 [μs]	输出采样平均值计算 [采样量]	输出采样周期 [ms]	无噪声 ENOB 电流测量
50	256	12.8	13.39
84		21.504	13.39
150		38.4	14.71
280		71.68	14.71
540		138.24	15.71
1052		269.312	15.71
2074		530.944	15.71
4120		1054.72	16
50	512	25.6	13.39
84		43	14.12
150		76.8	14.71
280		143.36	15.71
540		276.48	15.71
1052		538.624	15.71
2074		1061.888	16
4120		2109.44	16
50	1024	51.2	14.12
84		86.016	14.71
150		153.6	15.71
280		286.72	15.71
540		552.96	15.71
1052		1077.248	16
2074		2123.776	16
4120		4218.88	16

7.2 典型应用

INA701 的低失调电压可实现对宽范围内电流的精确监测。图 7-1 展示了用于在高侧配置中监测电流的电路。

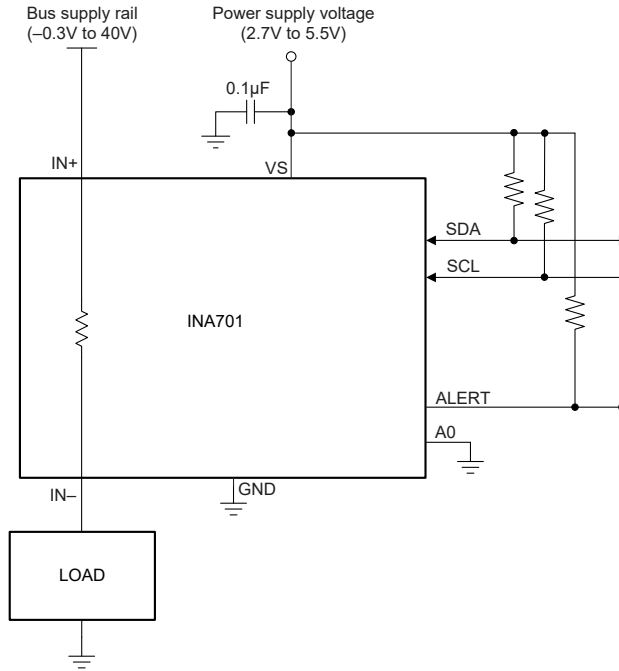


图 7-1. INA701 高侧感测应用图

7.2.1 设计要求

图 7-1 中所示的电路设计要求列在表 7-3 中。

表 7-3. 设计参数

设计参数	示例值
电源电压 (VS)	5V
总线电源轨 (VCM)	12V
总线电源轨过压故障阈值	14V
平均电流	2A
过流故障阈值 (IMAX)	4A
温度	40°C
电荷累积期间	1 小时

7.2.2 详细设计过程

7.2.2.1 配置器件

编程 INA701 的第一步是正确设置器件和 ADC 配置寄存器。初始上电时，CONFIG 和 ADC_CONFIG 寄存器设置为复位值，如表 6-5 和表 6-6 所示。在此默认上电状态下，器件设置为通过 ADC 持续转换温度、电流和总线电压。如果默认上电条件不符合设计要求，则必须在每次 VS 下电上电事件后正确设置这些寄存器。

7.2.2.2 设置所需的故障阈值

可通过将所需跳变阈值编程到相应的故障寄存器中来设置故障阈值。表 6-1 展示了支持的故障寄存器列表。

过流阈值通过对电流超限阈值寄存器 (COL) 进行编程来设置。必须编程到该寄存器中的值通过将过流限值除以电流 LSB 大小来计算。在此示例中，COL 寄存器的目标值为 $2A \div 190 \mu A = 10526d$ (291Eh)。

总线电压上的过压故障阈值通过对总线过压限制寄存器 (BOVL) 进行编程来设置。在此示例中，所需的过压阈值为 14V。必须编程到此寄存器中的值是通过将目标阈值电压除以 3.125mV 的总线电压故障限制 LSB 值来计算的。在此示例中，BOVL 寄存器的目标值为 $14V \div 3.125mV = 4480d$ (1180h)。

设置功率高于上限的值时，用于计算限制寄存器中所需值的 LSB 大小比电源 LSB 大 256 倍。这是因为电源寄存器的长度为 24 位，而电源故障限制寄存器的长度为 16 位。用于设置过功率故障限制的 LSB 值为 9.728mW。

在 V_S 下电上电事件后，存储在警报限制寄存器中的值将设置为默认值，并且必须在每次通电时重新编程。

7.2.2.3 计算返回值

通过将返回值乘以 LSB 值来计算参数值。假设设计要求如表 7-3 所示，表 7-4 展示了该应用示例的返回值。

表 7-4. 计算返回值

参数	返回值	LSB 值	计算得出的值
电流 (A)	10526d	190μA	2A
总线电压 (V)	3840d	3.125mV	12V
功率 (W)	631578d	38μW	24W
电能 (J)	142105263d	0.608mJ	86.4kJ
电荷 (C)	606315789d	11.875μC	7200C
温度 (°C)	320d	125m°C	40°C

二进制补码格式的电流、总线电压（仅正值）、电荷和温度返回值。采用二进制补码格式时，二进制中的负值表示为返回值的最高有效位中有一个 1。这些值可以转换为十进制，方法是首先反转所有位并加 1 以获得无符号二进制值。然后，可以将该值转换为十进制，并加上负号。例如，假设当前读数返回 1011 0100 0001 0000。因为 MSB 具有值 1，所以这是一个负值。将这些位取反后加 1，结果为 0100 1011 1111 0000 (19440d)，即电流值为 3.6936A。由于返回值为负值，因此测量的电流值为 -3.6936A。

7.2.3 应用曲线

图 7-2 和 图 7-3 展示了在温度、分流电压和总线电压测量的转换时间为 $50\ \mu\text{s}$ 、均值计算设置为 1 的情况下，ALERT 引脚对过流故障的响应。该配置使得全部三种测量的总转换时间为 $150\ \mu\text{s}$ 。对于这些示波器屏幕截图，在 ALERT 通道上启用了持久性，以显示许多顺序故障事件的警报响应变化。警报响应时间可能会根据故障发生前的电流值以及故障条件超过编程故障阈值的程度而变化。图 7-2 展示了当故障条件大大超出编程阈值时过流故障的响应时间。而图 7-3 展示了当故障略超出编程阈值时的过流响应时间。外部故障事件与内部 ADC 转换启动不同步，因此存在警报响应变化。此外，ADC 不断进行采样以获得结果，因此，从零开始的故障事件与从接近设定故障阈值的值开始的故障事件相比，前者的响应速度更慢。在警报时间对于过流事件至关重要的应用中，最坏情况警报响应等于 $2 \times t_{\text{conv_current}} + t_{\text{conv_temp}} + t_{\text{conv_voltage}} + 25\ \mu\text{s}$ 。额外添加了 $25\ \mu\text{s}$ 以进行后台数学计算。

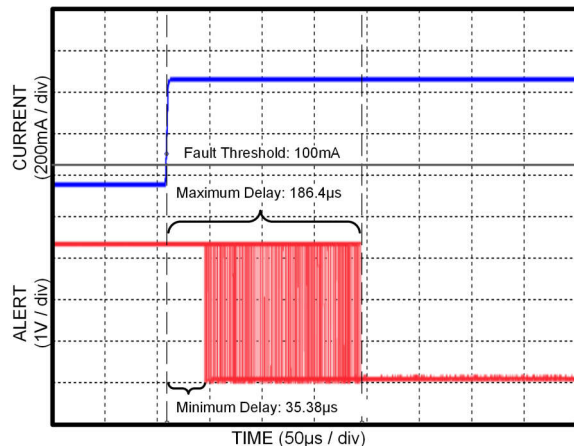


图 7-2. 警报响应时间 (采样值明显高于阈值)

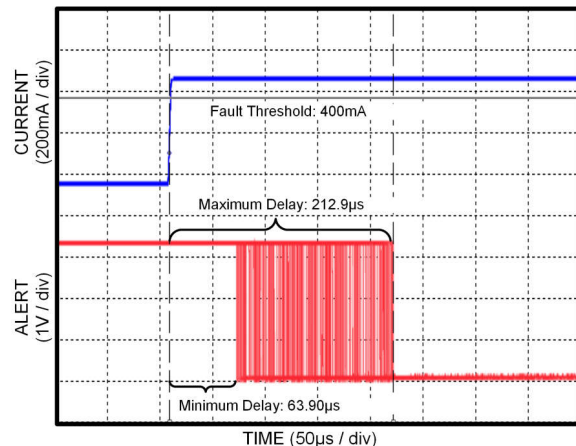


图 7-3. 警报响应时间 (采样值稍高于阈值)

8 电源相关建议

器件的输入电路可以在共模电压超出其电源电压 V_S 的情况下准确地测量信号。例如，施加到 V_S 电源终端的电压可以为 5V，而监测到的负载电源电压（共模电压）可以高达 40V。请注意，无论器件加电与否，该器件的输入终端也可以耐受整个 0V 至 40V 范围的电压。应避免在器件主动通电时 GND 引脚断开的情况。

将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源端子和接地端子放置。电源旁路电容器的容值通常为 0.1 μ F。采用高噪声或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。

9 布局

9.1 布局指南

在检测高负载电流时，布局需要能够尽可能地提高从 IN- 和 IN+ 焊盘的热传导，这一点至关重要。可以尽可能扩大连接到这些焊盘的散热平面的面积，填充任何可用区域，同时尽可能靠近器件。可以大量使用散热过孔，并将其尽可能靠近 IN- 和 IN+ 焊盘放置，以更大限度地提高到底部和可用内层的热传导。为了实现更好的热性能，可使用底层和可用的内层将热量从器件中传导出去。有关多层设计中过孔和电源平面布局的更多信息，请参阅 [INA701EVM 用户指南](#)。电源旁路电容器的位置应尽可能靠近电源引脚和接地引脚。

9.2 布局示例

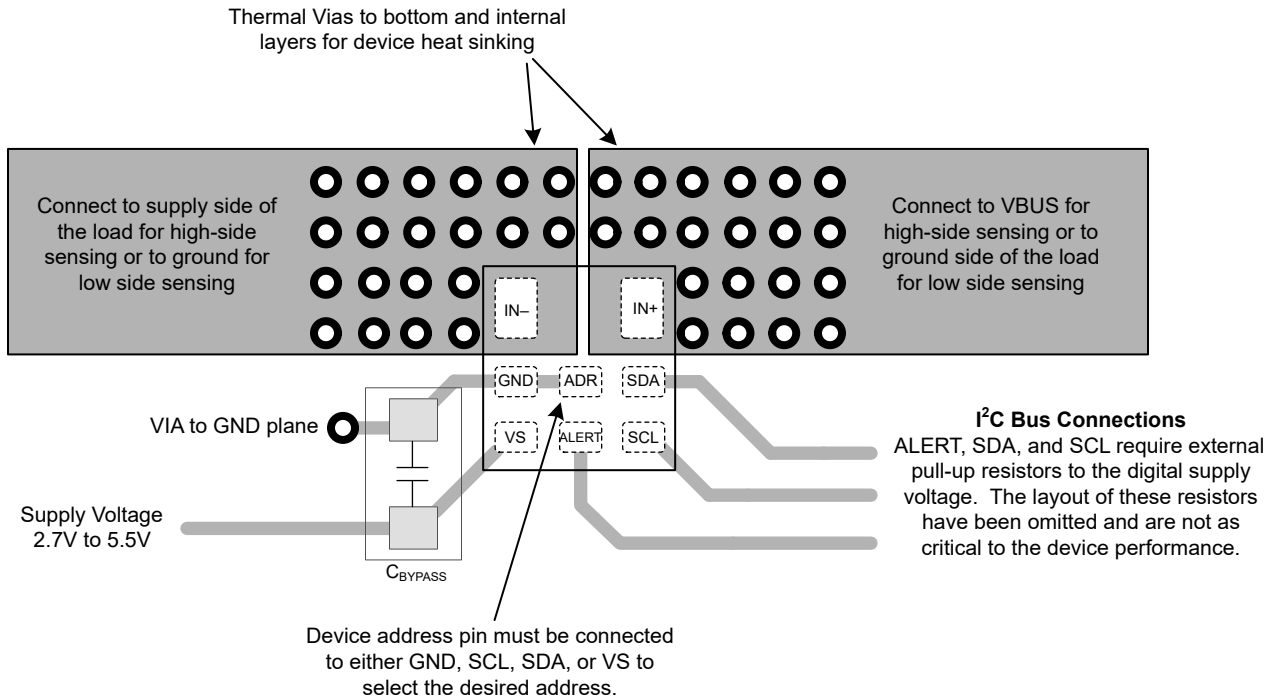


图 9-1. INA701 布局示例

10 器件和文档支持

10.1 文档支持

10.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [INA701EVM 用户指南](#)

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.4 商标

EZShunt™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

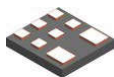
11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

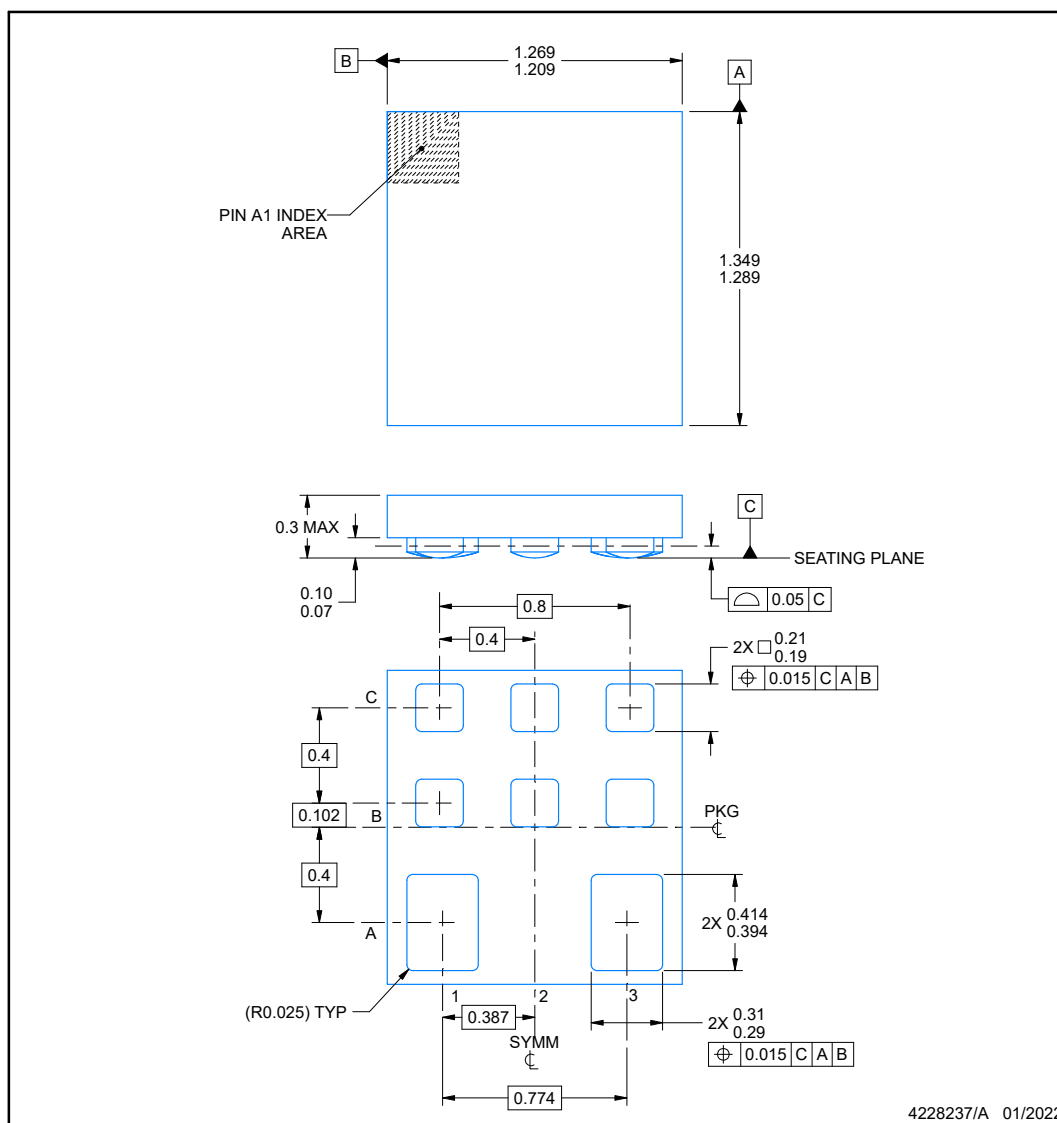
日期	修订版本	注释
August 2025	*	初始发行版

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

**PACKAGE OUTLINE****YWF0008A****PowerWCSP - 0.3 mm max height**

POWER CHIP SCALE PACKAGE

**NOTES:**

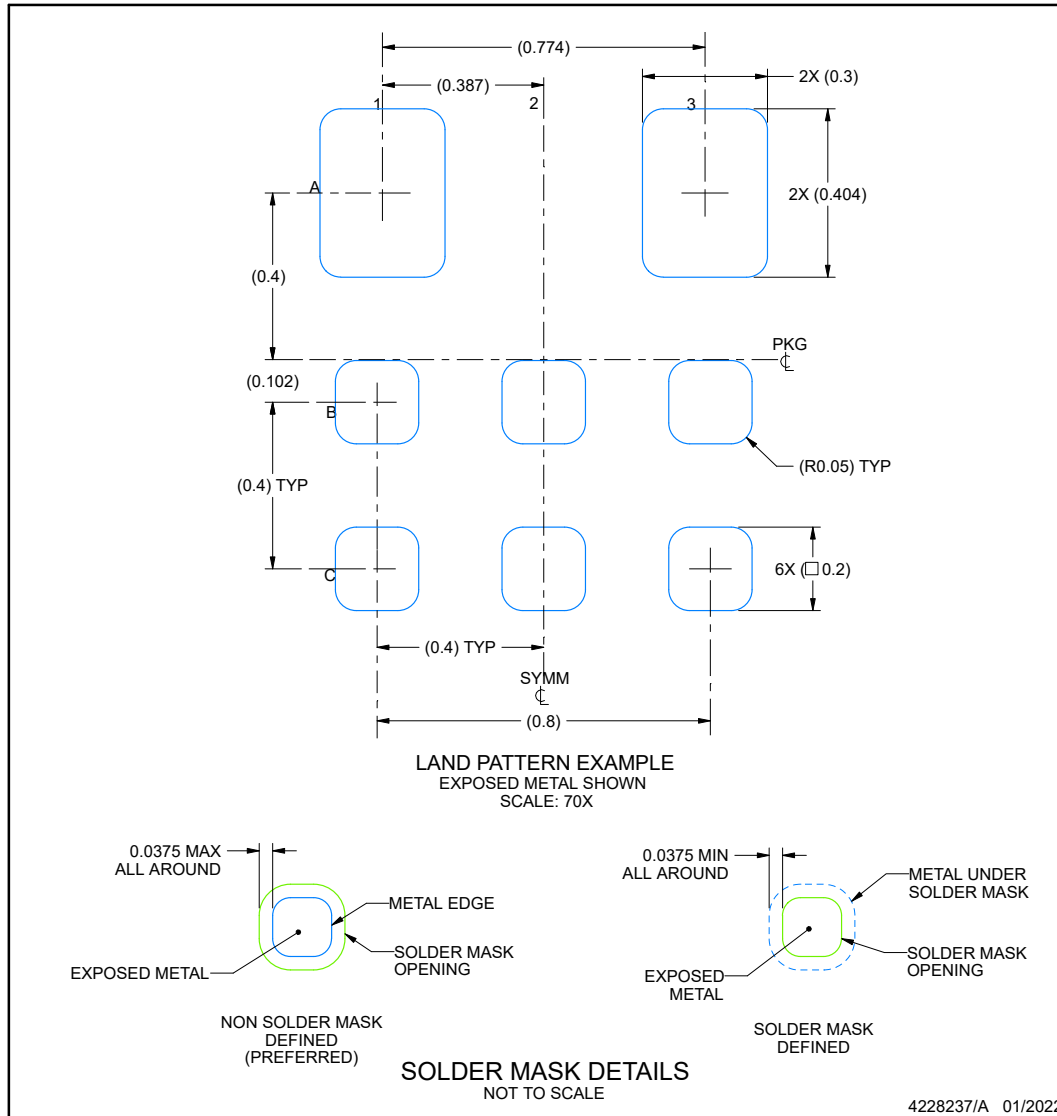
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

YWF0008A

PowerWCSP - 0.3 mm max height

POWER CHIP SCALE PACKAGE

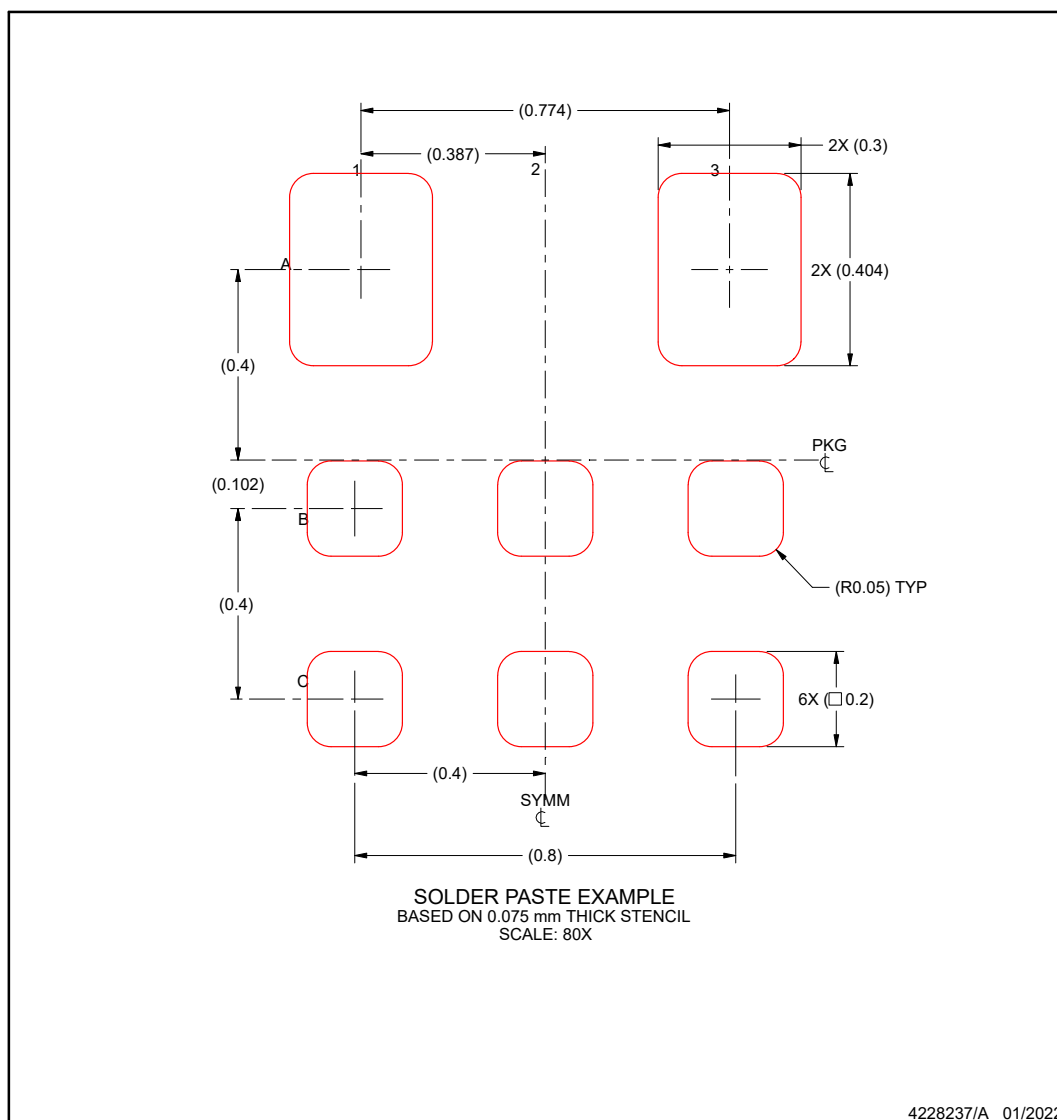


NOTES: (continued)

- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN**YWF0008A****PowerWCSP - 0.3 mm max height**

POWER CHIP SCALE PACKAGE



NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
INA701AYWFR	Active	Production	DSBGA (YWF) 8	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1B

- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
INA701AYWFR	DSBGA	YWF	8	3000	180.0	8.4	1.35	1.43	0.38	4.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
INA701AYWFR	DSBGA	YWF	8	3000	182.0	182.0	20.0

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月